## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-38656

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FΙ			
G03G	5/06	3 1 2	G 0 3 G	5/06	3 1 2	
		370			370	
	5/05	1 0 1		5/05	101	
		104			104B	

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 41 頁)

		(Ma) 11175 I	000005400
(21)出願番号	特願平9-190236	(71)出願人	
			宮士ゼロックス株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)7月15日		東京都港区赤坂二丁目17番22号
(DE) HIER H	1,000	(72)発明者	山田 渉
		(16)76914	
(31)優先権主張番号	特願平8-187932		神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
(32)優先日	平8 (1996) 7月17日		ックス株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	<b>額田 克</b> 己
(31)優先権主張番号	特顯平9-129039		神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
(/,	14-4-1		ックス株式会社内
(32)優先日	平 9 (1997) 5 月19日	[ ]	
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	岩崎、真宏
			神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
			ックス株式会社内
		(74)代理人	弁理士 中島 淳 (外4名)

## (54) 【発明の名称】 電子写真感光体

## (57)【要約】 (修正有)

【課題】 溶解性、成膜性、相溶性に優れた化合物を用い、強固な膜を形成させ、機械的強度の向上した、高感度で環境安定性に優れた電子写真感光体を提供する。

【解決手段】 複数の層で形成された電子写真感光体において、その1層が下記一般式(I)で表される化合物を1種以上含有する。この層は、さらにフッ素含有化合物の1種以上を含有してもよい。下記式中、Ar1~Ar4はそれぞれ独立にアリール基を示し、Ar5はアリール基又はアリーレン基を示す。Xは一Y-SiR1(3-a)(OR2) a で示される置換基を示し、ここで、R1は水素、アルキル基、アリール基を示し、R2は1~3の整数を示し、Yは2価の基を示す。但し、Yはヘテロ原子に直接結合した水素原子を有する2価の基、例えば、-CONH-、-NH-等を含まない。kはO又は1を示す。

一般式(I)

$$\left(\begin{array}{c} Ar_1 \\ Ar_2 \end{array}\right) N - Ar_6 - \left(N \left(\begin{array}{c} Ar_4 \\ Ar_4 \end{array}\right)_{k} + X$$

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の層で形成された電子写真感光体において、前記複数の層の少なくとも1層が下記一般式 ― 般式(!)

(I) で表される化合物を少なくとも1種以上含有する ことを特徴とする電子写真感光体。

【化1】

$$\left(\begin{array}{c}
Ar_1 \\
Ar_2
\end{array}\right) N - Ar_5 - \left(\begin{array}{c}
Ar_3 \\
Ar_4
\end{array}\right) X$$

式中、 $Ar1 \sim Ar4$  はそれぞれ独立に置換又は未置換のアリール基を示し、Ar5 は置換若しくは未置換のアリール基又はアリーレン基を示す。X は、-Y-S i R 1(3-a) (OR2) a で示される置換基を示し、ここで、R1 は水素、アルキル基、置換又は未置換のアリール基を示し、R2 は水素、アルキル基、トリアルキルシリル基を示し、a は  $1\sim 3$  の整数を示し、Y は 2 価の基を示し、Y は 2 価の基を含まない。Y は 2 任の基を含まない。Y は 2 任の表を含まない。Y は 2 任の表を含まない。Y は 2 任の表を含まない。Y は 2 任の表を含まない。Y は 2 任のようのいずれか  $1\sim 4$  個に結合する。

【請求項2】 前記一般式(I)で表される化合物を少なくとも1種以上含有する層が、さらに、フッ素含有化合物の少なくとも1種以上含有することを特徴とする請求項1に記載の電子写真感光体。

【請求項4】 前記フッ素含有化合物がフッ素含有シランカップリング剤であることを特徴とする請求項2又は3に記載の電子写真感光体。

【請求項5】 前記一般式(I)で表される化合物を少なくとも1種以上含有する層が、さらに、前記一般式(I)で表される化合物と相溶可能な材料を少なくとも1種以上含有することを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の電子写真感光体。

【請求項6】 前記一般式(1)で表される化合物と相溶可能な材料が絶縁性のポリマーであることを特徴とする請求項5に記載の電子写真感光体。

【請求項7】 前記一般式(I)で表される化合物を少なくとも1種以上含有する層を構成する全ての材料が、 互いに相溶可能な材料であることを特徴とする請求項1 乃至4のいずれかに記載の電子写真感光体。

【請求項8】 前記一般式(1)で表される化合物を少

なくとも1種以上含有する層を構成する全ての材料が、 -O-Si-O-結合を形成し得る材料であることを特 徴とする請求項7に記載の電子写真感光体。

【請求項9】 前記一般式(I)で表される化合物を硬化させたことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の電子写真感光体。

【請求項10】 前記一般式(I)で表される化合物を 硬化させる手段として硬化触媒を用いることを特徴とす る請求項9に記載の電子写真感光体。

【請求項11】 前記硬化触媒が酸性化合物であることを特徴とする請求項10に記載の電子写真感光体。

【請求項12】 前記一般式(I)で表される化合物を 含有する層が最表面に形成されたことを特徴とする請求 項1乃至11のいずれか1項に記載の電子写真感光体。

【請求項13】 電荷発生材料としてハロゲン化ガリウムフタロシアニン結晶、ハロゲン化スズフタロシアニン結晶、ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶及びオキシチタニルフタロシアニン結晶を少なくとも1種以上含有する層をさらに備えたことを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1項に記載の電子写真感光体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な化合物を用いた電子写真感光体に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】電子写真感光体の電荷輸送層を形成する材料としては、ポリビニルカルバゾール(PVK)等のように、電荷輸送成分を主鎖に含む電荷輸送性ポリマーと、トリアリールアミン等のような電荷輸送性の低分子化合物をバインダーポリマー中に分散させた低分子分散系のものどがよく知られている。このうち、低分子分散系のものが、材料の多様性があり、高機能のものが得られやすいことから、電子写真感光体では主流になっている。

【〇〇〇3】電子写真感光体に関しては、近年、有機感光体の高性能化に伴い、これが高速の複写機やプリンターにも使用されるようになってきたが、有機感光体を高速の複写機やプリンターに用いる場合、必ずしも現在の性能では十分でなく、特にさらなる長寿命化が切望され

ている。この有機感光体の寿命を決定する重要な因子の一つが表面層の磨耗である。現在の有機感光体では、電荷発生層の上に電荷輸送層を積層したいわゆる積層型のものが主流となっており、電荷輸送層が表面層となる場合が多い。そして、現在の主流である低分子分散系電荷輸送層では、電気的な特性に関しては十分に満足できる性能のものが得られつつあるが、低分子化合物がバインダーポリマー中に分散されるため、バインダーポリマー本来の機械的な性能が低下してしまい、磨耗に関しては本質的に弱いという欠点があった。

【〇〇〇4】上記の欠点を改善するため、現在までに多 くの方法が試みられており、その一つとして、電荷輸送 材料のポリマー化についての研究が盛んにされている。 例えば、米国特許第 4,806,443号明細書に は、特定のジヒドロキシアリールアミンとビスクロロホ ルメートとの重合によるポリカーボネートが開示されて おり、米国特許第 4,806,444号明細書には特 定のジヒドロキシアリールアミンとホスゲンとの重合に よるポリカーボネートが開示されている。また、米国特 許第4、801、517号明細書にはビスヒドロキシア ルキルアリールアミンとビスクロロホルメート又はホス ゲンとの重合によるポリカーボネートが開示されてお り、米国特許第4、937、165号明細書及び米国特 許第4,959,288号明細書には、特定のジヒドロ キシアリールアミン若しくはビスヒドロキシアルキルア リールアミンとビスクロロホルメートとの重合によるポ リカーポネート、又は、特定のジヒドロキシアリールア ミン若しくはビスヒドロキシアルキルアリールアミンと ビスアシルハライドとの重合によるポリエステルが開示 されている。さらに、米国特許第5、034、296号 明細書には、特定のフルオレン骨格を有するアリールア ミンのポリカーボネート又はポリエステルが開示され、 また、米国特許第4、983、482号明細書には、ポ リウレタンが開示されている。さらにまた、特公昭59 一28903号公報には、特定のビススチリルビスアリ ールアミンを主鎖としたポリエステルが開示されてい る。また、特開昭61一20953号公報、特開平1一 134456号公報、特開平1-134457号公報、 特開平1―134462号公報、特開平4―13306 5号公報及び特開平4一133066号公報等には、ヒ ドラゾンや、トリアリールアミン等の電荷輸送性の置換 基をペンダントとしたポリマー及びそれを用いた電子写 真感光体も提案されている。しかし、上記の高分子電荷 輸送材料は感度、残留電位等の点で十分でなく、電子写 真感光体としての耐久性も十分でない。

【0005】また、低分子電荷輸送材をバインダーポリマー又はポリマー前駆体中に分散し、その後バインダーポリマー又はポリマー前駆体を反応硬化させる方法が提案されている。例えば、特開昭56-48637号公報及び特公昭56-42863号公報にはアクリル系ポリ

マーを用いる例が、特公平5-47104号公報、特公昭60-22347号公報及び特公平7-120051号公報にはシリコン系ポリマー又はポリマー前駆体を用いる例がそれぞれ示されている。しかし、電子写真感光体としての十分な特性を得るためには、低分子電荷輸送材料の濃度を30~50%と高くする必要があるため、バインダーの硬化反応が十分に進まず、バインダーポリマー間から低分子電荷輸送材が抜け出し、磨耗してしまうため、問題の解決には至っていない。

【0006】また、電子写真感光体表面の潤滑性を高めるために、特開昭57-5050号公報、特開昭61-219049号公報及び特開昭62-205357号公報には、シリコーン含有ポリマーを添加する例が、特開昭50-23231号公報、特開昭61-116362号公報、特開昭61-204633号公報及び特開昭63-65449号公報には、フッソ含有ポリマーを添加する例が、特開昭63-65449号公報には、シリコーンポリマー微粒子を添加する例が、特開平2-144550号公報にはフッソポリマー微粒子を添加する例が、特開平2-144550号公報にはフッソポリマー微粒子を添加する例が、特開平2-144550号公報にはフッソポリマー微粒子を添加する例がそれぞれ提案されているが、いずれも電荷輸送材料ではバインダーポリマーとの相溶性が悪く、感光層中ではいるが、いずれも電荷輸送材料を起こし、不透明な膜になり電気特性を悪化させてしまう。

【0007】また、感光層に強固な樹脂の微粒子を添加するような方法が提案されている。例えば、特開昭60-177349号公報には、メラミン樹脂微粒子を添加する例が示されているが、この方法も電荷輸送材又はバインダーポリマーとの相溶性が悪く、感光層中で層分離を起こし、不透明な膜になり電気特性を悪化させてしまう。

【0008】また、電子写真感光体表面を保護するために、特開昭56-38055号公報及び特開昭60-55355号公報にはイミド系のポリマーを、特開昭59-185347号公報及び特開昭61-217052号公報にはメラミン系のポリマーを、特開昭59-46652号公報にはアクリル、メラミン系のポリマーを、

「Proceedings of IS&T's Eleventh International Congress on Advances in Non-Impact Printing Technologies」の57~59頁及び特開平8-15886号公報にはゾルゲル法によるシロキサン系のポリマーを、マンカによる無機質薄膜を表面保護層に用いた方法が提案でしたる無機質薄膜を表面保護層の多くは、残留電にいる。しかし、上記の表面保護層の多くは、残留電位を上昇させる等の欠点がある。「Proceeding of IS&T's Eleventh International Congress on Advances in Non-Impact Printing Technologies」の57~59頁に記

載のゾルゲル法を用いた方法は、残留電位、強度等で有利であることが示されているが、使用した化合物の具体的な構造については全く示されていない。

【0009】更に、同様なゾルーゲル法を用いる方法と して、上記のゾルゲル法の材料の一つに電荷輸送能を持 たせる方法が特開平3-191358号公報に提案され ている。ここで開示されている化合物はウレタン結合を 用いるもののみであり、この化合物を用いると確かに電 荷輸送層としての強度は増すが、水素結合を形成しやす く、大気中の水分を吸着しやすいヘテロ原子に直接結合 した水素原子有するため、放電生成物や湿気の影響を受 けやすく、多数回の繰り返し使用や高温高湿下での使用 において画像流れを起こしやすく長期に渡って安定な画 像を得ることは難しい。また、近年になりトリフェニル アミン骨格に炭素ー炭素の重合性2重結合を持つ電荷移 動性単量体を単独、若しくはバンダーポリマーに添加し て、光又は熱によって重合させることにより強固な膜を 形成させる方法が特開平フーフ2640号公報に提案さ れているが、重合部位が一つしかないため、架橋密度が 上がらず、電子写真感光体としての十分な耐久性は得ら れていない。

[0010]

一般式(1)

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、溶解性、成膜性、相溶性に優れた化合物を用い、強固な膜を形成させ、機械的強度の向上した、高感度で環境安定性に優れた電子写真感光体を提供することにある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題に対し鋭意検討した結果、複数の層で形成された電子写真感光体において、前記複数の層の少なくとも1層が特定のシラン化合物を含有することにより、溶解性、成膜性に優れた電子写真感光体を提供することが可能であることを見いだし、特にヘテロ原子に直接結合した水素原子を持たないシラン化合物を用いた場合に大気中の水分を吸着しにくいため、放電生成物や湿度の影響を受けにくく環境安定性の優れた電子写真感光体を提供することが可能であることを見いだし、本発明を完成するに至った。

【 O O 1 2 】即ち、本発明は、複数の層で形成された電子写真感光体において、前記複数の層の少なくとも1層が下記一般式(I)で表される化合物を少なくとも1種以上含有することを特徴とする。

[0013]

【化2】

$$\left(\begin{array}{c}
Ar_1 \\
Ar_2
\end{array}\right) N - Ar_5 - \left(\begin{array}{c}
N \\
Ar_4
\end{array}\right) k$$

【〇〇15】また、本発明の電子写真感光体の別の態様

は、前記一般式 (I) で表される化合物を少なくとも 1 種以上含有する層に、さらに、フッ素含有シランカップ リング剤等のフッ素含有化合物を含有することを特徴と する。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。 【0017】本発明のシラン化合物は前記一般式(I) で表される。式中、Arl ~ Arl はそれぞれ独立に置 換又は未置換のアリール基を示し、具体的には、以下の ものが挙げられる。

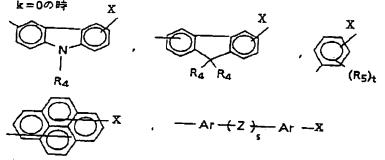
[0018]

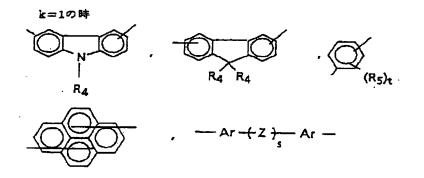
【化3】

$$X_m$$
 $X_m$ 
 $X_m$ 

【〇〇19】また、一般式(I)中、kはO又は1を示し、Ar5 は置換若しくは未置換のアリール基又はアリーレン基を示し、具体的には、以下のものが挙げられ

る。 【0020】 【化4】





【OO21】ここで、Xは-Y-Si  $R_1(3-a)$ (OR2)aを示す。 $R_1$  は水素、炭素数  $1\sim 1$ 0のアルキル基、炭素数  $1\sim 4$ 0のアルキル基若しくは炭素数  $1\sim 4$ 0アルコキシ基で置換された置換又は未置換のアリール基を示し、 $R_2$  は水素、炭素数  $1\sim 4$ 0アルキル基で置換されたトリアルキルシリル基を示す。 Yは 2 価の基を示し、好ましくは、-( $CH_2$ ) $_X$ -、-( $C_{X'}$ H $_{2X'}$ - $_2$ )-、-( $C_{X''}$ H $_{2X''}$ - $_4$ )-、置換又は未置換のアリーレン基、-CH=N-、-O-D0 -COO-D0 -COO-

であり、ここで Y' は一( $CH_2$ )  $_X$  一、一( $C_{X'}H_{2X'-2}$ )一、一( $C_{X''H_{2X''-4}}$ )一、置換又は未置換の アリーレン基、一CH=N-、一〇一及び一COO-を 少なくとも 1 種以上含有する 2 価の基を表す。但し、 Y はヘテロ原子に直接結合した水素原子を有する 2 価の基、例えば、一CONH-、一NH-等を含まない。また、 $_X$  は 1 ~ 1 5 の整数、 $_X$  なび  $_X$  " はそれぞれ 2 から 1 5 の整数である。

**【OO22】Yとして具体的には、以下のものが挙げられる。** 

【0023】 【化5】

$$-(CH_2)_x - \qquad , \qquad -(C_{x'}H_{2x'-2}) - \qquad , \qquad -(C_{x''}H_{2x''-4}) - \qquad + C \cap O - \ .$$

-N = CH.

【化6】

 $-(C_{x}^{"}H_{2x}"-4)$ -

$$(R_5)_t \qquad (R_5)_t \qquad (CH_2)_y \qquad (CH_2)_{t^{-1}}$$

$$(R_5)_t \qquad (R_5)_t \qquad (R_5)_t$$

【0024】この中では、特に以下のものが好ましい。 【0025】

-(CH<sub>2</sub>)<sub>x</sub> -

. -(Cx'H2x'-2)-

【0026】上記の $Ar_1 \sim Ar_5$  のうち  $1 \sim 4$  個は、X、即ち、-Y-Si  $R_1(3-a)$  ( $OR_2$ ) a で示される 置換基を有していることが必要であり、ここで k が 0 のとき、X は  $Ar_1$  、 $Ar_2$  、 $Ar_5$  のいずれか  $1 \sim 4$  個に結合する。

【OO27】また、Arは以下の基から選択される。

[0028]

[4t 7]  $(R_5)_t \qquad (R_5)_t$   $(R_5)_t \qquad (R_5)_t$ 

【0029】さらに、Z'は以下のものから選択される。

[0030]

【化8】

【0031】また、Zは以下のものから選択される。 【0032】 【化9】

$$-(CH_2)_{q^-}$$

$$-(CH_2CH_2O)_{r^-}$$

$$-(CH_2CH_2O)_{r^-}$$

$$-(CH_2CH_2O)_{r^-}$$

$$-(CH_2CH_2O)_{r^-}$$

$$-(R_6)_{t'}$$

$$-(R_6)_{t'}$$

$$-(R_6)_{t'}$$

【0033】さらに、Wは以下の基から選択される。

【化10】

[0034]

$$-CH_2 - , -C(CH_3)_2 - , -O- , -S- ,$$
  $CH_2$   $CH_$ 

【0035】また、R4 は水素、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルキル基若しくは炭素数1~4のアルコキシ基で置換された置換又は未置換のフェニル基、炭素数7~10のアラルキル基から選択される。さ

らに、R5 は水素、炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基、炭素数  $1 \sim 4$  のアルコキシ基、ハロゲン原子から選択される。また、R6 は水素、炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基から選択される。m及び s はそれぞれ 0 又は 1 を示し、 t 及び a

はそれぞれ  $1 \sim 3$ の整数を示し、y 及びz はそれぞれ  $1 \sim 5$  の整数を示す。また、x は  $1 \sim 1$  5 の整数を示し、x' 及びx'' はそれぞれ  $2 \sim 1$  5 の整数を示す。さらに、s' は  $0 \sim 3$  の整数を示し、t' は 1 又は 2 の整数を示し、q 及びr はそれぞれ  $1 \sim 1$  0 の整数を示す。

【0036】また、Ar1 ~Ar5 のうち少なくとも1 k=0の時 つは2つ以上の共役した芳香族を有するものが光酸化に 対して安定であり好ましい。

【0037】なお、Ar5 は以下のものがより好ましい。

[0038]

【化11】

(7)

$$(R_5)_t$$
  $(R_5)_t$   $(R_5)_t$   $(R_5)_t$   $(R_5)_t$   $(R_5)_t$ 

【OO39】一般式(I)のシラン化合物の具体例を表  $1\sim13$ に示す。下記表において、Xの付加位置はそれ ぞれの $Ar_1\sim Ar_5$ の欄に示し、そこに付加するXの

具体例をXの欄に示してある。

[0040]

【表 1 】

$$\left\{\begin{array}{c} Ar_1 \\ Ar_2 \end{array}\right\} N - Ar_4 - \left(N \left(\begin{array}{c} Ar_4 \\ Ar_4 \end{array}\right)_{k} \right) X$$

化合物	k	Arı	Ar <sub>2</sub>	Ar3	Ar4	Ar5	х
1	0	-Ø- M+	-0-0			- <b>©</b> - x	-CH = CH-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OMe) <sub>3</sub>
. 2	0	Me Ma	-0-0		<u></u>	- <b>©</b> - x	-CH = CH-(CH <sub>B</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OEL) <sub>3</sub>
3	0	Ме - Ме.	- <b>©</b> - <b>©</b>			- <b>⊙</b> - x	-CII=CII-CII <sub>3</sub> -SI(OMe) <sub>1</sub> Me
4	0	М•	<b>O-O</b>	•		- <b>©</b> - x	-CH = N-(CH <sub>9</sub> ), -Si(OMe) <sub>9</sub>
5	0	Me Me	-0-0			- <b>©</b> - x	-CH = N-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OEt) <sub>2</sub>

				<del>,                                     </del>
×	-(CH,),-Si(OMe),	O-(CH <sub>2</sub> ),	-CH = CH-(CH <sub>1</sub> );	.CH = N.(GH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>
År5	×	×	r r r	ż þ
Arą			Me Me	M. — M.
Ar3			ě	Š
Arz	0-0	0	0-0	0
Arı	Me -Ó- Me	Me	•м ————————————————————————————————————	Me Me
<b>,</b> ¥,	0	0	<b>-</b>	<b>174</b>
化合物	9	7	∞	6

×	·CH = CH·(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	-CH = N·(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OMe) <sub>3</sub>	.CH = CH-(CH <sub>3</sub> );	.CH = CH-(CH <sub>3</sub> );	-CH=CH·CH <sub>2</sub> -Si(OMe) <sub>t</sub> Me
Ar5	, O	ŏ	N. M.	W. Me	Me Me
Ar4	l		. Me	•M → M•	Me -O- Me
Ar3			x	x-Q-	x - 🕞
Ar2	-Ø-x	×	x Ø-	х-Ф	x - 🕞
Arı	0	© ©	Me	Me ————————————————————————————————————	Me
ķ	0	0	#	1	1
化合物	1.0	1.1	1.2	13	1.4

[0043]

х	.CH = N.(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	.CH=N-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OEt) <sub>3</sub>	-(CH;),-Si(OMe),	.0.(CH <sub>2)3</sub> .Si(OE1) <sub>3</sub>
Ars	Me Me	Me Me	Me Me	W W
Ar4	Me	Me	Me ————————————————————————————————————	Me
Ar3	x -Ø-	x- <b>Q</b> -	Ď	× -©
Ar <sub>2</sub>	ф-х	×	×	×
Arı	Me Me	9W - Q-	Me Me	Me
×	1	1	H	П
化合物	1 5	1 6	17	1 8

[0044]

【表5】

×	.CH = CH.(CH,),	.CH = N.(CH <sub>9</sub> ) <sub>2</sub>	.(CH <sub>p</sub> ),Si(OEl),	.04CH2)3
Ars	, Š	Ď	, Ø	Ď
Arq				
Ar3		l		Ì
Ar2	×-Ф	x - Ø	x-0	x-Q-
Arı	19 0 -Q-x -Q-x	x-Q- x-Q- 0	21 0 O-x O-x	x-Q- x Q- 0
ᅺ	0	0	0	0
化合物	. 1 9	2 0	2.1	2 2

[0045]

【表6】

х	.CH = CH.(CH <sub>3</sub> ); Si(OMe) <sub>3</sub>	-CH = N-(CH <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OMe) <sub>3</sub>	ęило):S- <sub>(-</sub> (но)-	-O-(CI1 <sub>2)3</sub> -Si(OMe <sub>13</sub> Me
Ars	M. M.	Me Me	Ne Me	, Me
Ar4	x- <b>Q</b> -	×-@-	×-Ø	×
Ar3		xQ-	x-0-x	x-Q- x -Q- x
Ar <sub>2</sub>	- x - Q - x	x-Q-   x-Q-	x - Ø-	х <b>-</b> Ф
Ar <sub>1</sub>	x -Q-	x - 🗇	x -©	x - 0
Ж	Н	1	1	1
化合物	2 3	2.4	2 5	2 6

化金物	k	Arı	Ar2	Ar <sub>3</sub>	Ar <sub>4</sub>	Ar <sub>5</sub>	х
2 7	0	-6 м.	~ <b>©</b> — <b>©</b>			<b>-</b> Ф- ×	-CH=CH-Si(OEU3
28	0	Ме — ме	<b>-</b>	<u> </u>		z -@-	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OE1) <sub>3</sub>
2 9	0	-6 м.	-0-0			- <b>©</b> - x	-CH = CH-C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> - Si(OMe) <sub>1</sub>
3 0	0	—— м. Ме	0		_	<b>-</b> ⊕-x	-(CH3)3-C*H4-
3 1	0	-ф- м.	-0-0			- <b>Q</b> ×	-CH = CH-C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> - (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OM <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>
3 2	0	- <b>⇔</b> - ¥.	-0-0			ф×	-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OHo) <sub>8</sub>

[0047] \_. \_

【表8】

化合物	k	Ar <sub>1</sub>	Ar <sub>2</sub>	Атэ	Ara	Ar5	x
3 3	1	- Мо Мо	- <b>⊘</b> - x	-Q-x	-Q- N°	**************************************	-CH = CH-SHOE+) <sub>0</sub>
3 4	1	-ф- м.	-©- z	- <b>⊘</b> x	Me Me	*• • •	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -S((OBL) <sub>8</sub>
3 5	1	-Ф- м.	-O-1	- <b>©</b> - x	-Ø- M•	м. м.	-CH = CH-C <sub>4</sub> H g(oMo)3
3 6	1	-Ø- м.	<b>- →</b> ×	-© ×	-G- к <sub>е</sub>	W	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>F</sub> -C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> - SKOMe) j
3 7	. 1	Me Me	- <b>©</b> - ×	-©- ×	Ме Ме	ж. -О-О-	-CH=CH-C <sub>1</sub> H <sub>4</sub> - (CH <sub>2</sub> ); -S((ON-0) <sub>2</sub>
3 8	1	Me Me	ф ×	-©-×	Me Me	M. M.	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OM+) <sub>3</sub>

[0048]

化合物	k	Arı	Ar2	Агз	Ar4	Ar5	х
101	0	Ме - — Ме	Me Ma			- <b>©</b> -x	-COU4CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> . Si(OMe) <sub>3</sub>
102	0	Ме и.	м. -О- м.			- <b>⊘</b> - x	-COO-CH <sub>3</sub> C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> . (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OMe) <sub>3</sub>
103	.0	Ne 	м. - О- м.			- <b>⊙</b> - ×	CH2-COO-(CH4)2- Si(ONe)3
104	. 0	—— Me	Me ——— Me			- <b>©</b> -x	CH <sub>2</sub> -CDO- CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -
105	0	- <del>О</del> - м.	-Ф- м.			-©- ×	(СН <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> -21(ОМФ) <sup>2</sup> -(СН <sup>5</sup> ) <sup>2</sup> -СОО-
106	0	- <del>О</del> - и.	М <sub>1</sub>				CH <sup>2</sup> C <sup>2</sup> H <sup>2</sup> -COO- CH <sup>2</sup> C <sup>2</sup> H <sup>2</sup> -COH <sub>2</sub> ) <sup>2</sup> -
107	Q	-6- м.	-0-0			- <b>⊘</b> - ×	-COO-(CH <sub>2)3</sub> - Si(OMe) <sub>3</sub>
108	a		-0-0			- <b>⊘</b> - x	-C00-CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> .
109	0	-Ф- и»	-0-0	_		- <b>⊘</b> - x	-СН <sub>2</sub> -СОО-(СН <sub>2</sub> )-
110	0	-⊕- и.	-0-0			-©- x	-CH <sub>2</sub> -COO- CH <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - SKOMe) <sub>3</sub>
111	0	-Ø- Me	-0-0			- <b>©</b> - x	-4CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO- (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -6(OM <sub>0</sub> ) <sub>3</sub>
112	0	-Ф- н.	-0-0			- <b>⊘</b> - x	-4CH2/2-COO- CH4C6H4-4CH3/2- SKOM6/2
113	0	-Ф- и.	<b>-©</b> - ме			- <b>ø</b> ×	-COD-4CH <sub>1</sub> 1 <sub>3</sub> - SxOMe1 <sub>3</sub>

【表10】

[0049]

		т —			<del>- ,</del>			
112	合物	k	Ar <sub>1</sub>	Ar2	Ara	Ar4	Ars	x
1	14	0	-O- Ma	-0-	м.		- <b>ø</b> ×	-COO-CH <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> - (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Si(OM <sub>0</sub> ) <sub>2</sub>
1	15	0	-О- м.	-⊙-,	4.		-Ø *	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO. (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OM <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>
11	16	0	-О- же	м-Ф-			<b>-</b> ∅*	-(CH <sub>2</sub> I <sub>2</sub> -COO. CH <sub>2</sub> C <sub>2</sub> K <sub>2</sub> -(CH <sub>2</sub> I <sub>2</sub> - Si(O M <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>
11	17	0	-O- N.	Me Me			<b>O</b> -O-	_COO-(CH2)}.
11	В	0	Me Me	м <sub>а</sub>			-O-O-x	-COO-CH <sub>4</sub> -
119	,	0	Ме	-0			- <b>O</b> -O- x	-COO-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - Si(OM <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>
120		0	Me Me	-0			-Ø-Ø- x	-COO-(CH <sub>9</sub> ) <sub>3</sub> - Sk(OMe) <sub>3</sub>
121		0	-0	<b>⊘</b> - x		_	- <b>⊙</b> -×	-CH <sub>2</sub> -C00-ICH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -
122		0	-0	-⊙- x			- <b>⊘</b> - x	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -COO. (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OM <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>
123	$\perp$	0	-0	<b>~</b> ©~ x			- <b>⊘</b> - x	CH <sup>2</sup> C <sup>2</sup> H <sup>4,</sup> (CH <sup>2</sup> ) <sup>2,</sup> -(CH <sup>2</sup> ) <sup>2,</sup> COO-
124		0	-Ф− м.	~©- x			©- x	-CH <sub>2</sub> -COO- CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - SKONa) <sub>3</sub>
125		0	-О- м.	-⊙- x	_		—©- x	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO- (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OMe) <sub>3</sub>
126		0	-О- ме	<b>-©</b> - x			- <b>©</b> -×	-(CH <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> )- Si(OM <sub>2</sub> )-

[0050]

		Ţ				<del></del>		
1	七合物	k	Ar <sub>1</sub>	Ar2	Ar <sub>3</sub>	Ar4	Ar5	х
	127	0	_ Me		x -			-CH <sub>1</sub> -COO- CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> l <sub>2</sub> - Si(ONe) <sub>3</sub>
	128	0	-Q- M	<b>-○</b> -,			—⊚- x	-(CH2)-CDO-
	129	0	-б- м.	-©- ×			—◎- x	-{CH <sub>2</sub> }-COO- CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -Si(OM <sub>6</sub> ) <sub>3</sub>
1	.30	0	₩ <sub>0</sub>	-©- x			— <b>©</b> — ×	-{CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -COO- CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - Si(OM <sub>0</sub> ) <sub>3</sub>
	131	0	-0-0		_		- <b>⊘</b> -×	-CH <sub>2</sub> -COO-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - SHOMe) <sub>8</sub>
1	32	0	-0-0	- <b>⊘</b> - x			— <b>⊙</b> – x	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO. (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -Si(DM <sub>0</sub> ) <sub>3</sub>
1:	33	0	-0-0	-⊙-×			- <b>⊘</b> -×	-(CH <sub>1</sub> ) <sub>2</sub> -COO. CH <sub>2</sub> C <sub>9</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> SKOM <sub>9</sub> ) <sub>3</sub>
13	14	0	Me Me	-O-O-x		_	-O-O-x	coo-(си <sup>в)2</sup> -
13	5	0	Me Me	- <b>⊘</b> -∞-x			- <b>©</b> ∞-x	-COO-CH3C*H*-
130	B	0	-О₌ом•	- <b>©</b> - x			⊘ x	-CH <sub>3</sub> -COO- CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> -(CH <sub>3</sub> ) <sub>1</sub> - Bi(ONa) <sub>3</sub>
137	-	0	- <b>Q</b> -om•	- <b>⊘</b> - x			— <b>⊘</b> – x	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO- (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -S(OMe) <sub>3</sub>
138		0	-O-om.	-©- ×			— <b>©</b> — х	-(CH <sub>1</sub> ) <sub>2</sub> -COO. CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - SXOMe) <sub>3</sub>
139		0	М. м.	-Ø*			-ø×	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO- (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OM <sub>B</sub> ) <sub>3</sub>

[0051]

【表12】

化合	物 k	Arı	Ar <sub>2</sub>	Ar <sub>3</sub>	Ar <sub>4</sub>	Δ==	
	-			123	- A14	Ar <sub>5</sub>	X
140	0	М•	-€ ×		_	-€ x	-{CH <sub>1</sub> ) <sub>2</sub> -COO. CH <sub>1</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -S((OM <sub>8</sub> )
141	0	же — ме	-ø*			-ල*	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>8</sub> -COO- CH <sub>2</sub> C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - Si(OM <sub>6</sub> ) <sub>3</sub>
142	0	-0-0	-Ø*			- <b>⊘</b> ×	-CH <sub>2</sub> -COO-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -
143	0	-5-0	- <b>⊘</b> *			-ල ×	-(CH2)3-C00-
144	0	-0-0	-Ø <sup>x</sup>			- <b>⊘</b> ×	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO- CH <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>1</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - Si(OMa) <sub>3</sub>
145	1	-G- Me	- <del>Q</del> - x	<b>-⊙</b> - x	Me Me	W	-COO-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> - Si(OMa) <sub>3</sub>
146	1	Me Me	-O-x	- <b>©</b> - x	-O- м.	м. м.	COD-CH3C*H4-
147	1	-O- M.	- <b>©</b> - x	-©- x	Ме ме	-0-0"	-CH <sub>2</sub> -COO-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - Si(DM <sub>0</sub> ) <sub>3</sub>
148	1	м.	-Ø- x	- <b>⊙</b> - x	Me - Me	Me Me	-CM <sub>3</sub> -COO- CM <sub>2</sub> C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - Si(OMe) <sub>3</sub>
149	1	Me Me	-⊙-×	- <b>©</b> - x	-G- Ma	M. M.	≺CH37-GKOMeP
150	1	Me Me	-Q- x	-@- z	Me Me	M. M.	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COO- CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - SKONe) <sub>3</sub>
151	1	-©	-©- x	-Ф- х	-©	Me Ma	-COO-CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -
152	1	•	-O- x	- <b>⊙</b> - ×	-©	м. м.	.СН <sub>2</sub> -СОО-(СН <sub>2</sub> Ь-

[0052]

化合物	k	Ar <sub>1</sub>	Ar <sub>2</sub>	Агз	Ar4	Ar <sub>5</sub>	х
153	1	-©	-©- x	-Ø ×	Ф	M. M.	-CH <sub>2</sub> -COO-CH <sub>3</sub> -
154	1	•	-Ø- x	-©-×	•	M• M•	-CH <sub>3</sub> -COO- CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -(CH <sub>6</sub> ) <sub>3</sub> - SXOMel <sub>3</sub>
155	1	-0	-©- ×	<b>©</b> ×	Ф	Me Me	-COH <sub>2</sub> 1 <sub>2</sub> -COO- (CH <sub>2</sub> 1 <sub>2</sub> -cOO-
156	1	-0	- <b>©</b> - x	- <b>©</b> -×	P	₩• <b>→</b>	Skomei <sup>2</sup> CH <sup>2</sup> C <sup>2</sup> H°4CH <sup>2</sup> F- 4CH <sup>2</sup> F-COO-
157	1	-0	-Ø-Ø-×	• • ×	-©	-0-0-	-COO-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> - Si(OMa) <sub>3</sub>
158	1	<b>-</b> Ø	-Ø-Ø-×	-Q-Q-×	-0	-0-0-	.COO.CH <sub>T</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> . SKOMel <sub>9</sub>
159	1	Φ	-O-O- x	-O-O-x	•	-0-0-	.COO-CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> . (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si(OMa) <sub>3</sub>
160	1		ф×	- <b>©</b> - ×	м.	<b>0-0-0</b> -	-СОО-(СН <sub>э)г</sub> - 5ХОМ«) <u>3</u>
161	1	Me Me	-©- ×	- <b>©</b> - x	-Ф- и.	<b>@-@-@</b>	.СОО-СН <sub>1</sub> -С <sub>1</sub> Н <sub>4</sub> - БХОМ») <u>5</u>
162	1	- Me	-⊙- х	- <b>⊘</b> - x	-Ф и.	<del>-</del>	-COO-CH <sub>E</sub> G <sub>E</sub> H <sub>4</sub> - (CH <sub>2</sub> ) <sub>F</sub> Si(OMe) <sub>E</sub>
163	1	Me Me	-Ø- ×	- <b>©</b> - ×	-Ф- и.	@-@-@-	-CH-COO-(CH <sub>1</sub> )- SKOMe) <sub>3</sub>
164	1	Me Me	- <b>⊘</b> - x	- <b>∅</b> -×	₩•	<b>0-0-0</b>	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COQ- (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -Si(OMe) <sub>3</sub>
165	1	-Ø- Me	- <b>©</b> -×	-Ø- x	Me -Ø− Me	<b>-0-0-0</b>	-CH <sub>2</sub> P2-COO- CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -CH <sub>2</sub> P3- Si(OMo) <sub>2</sub>

【0053】上記シラン化合物は、導電性基板上に電荷 発生層及び電荷輸送層が形成された電子写真感光体や、 導電性基板上に電荷発生層及び電荷輸送層が形成され、 さらに最表面に表面保護層が形成された電子写真感光体 への応用が可能である。例えば、上記一般式(1)で示 されたシラン化合物を電荷輸送材料として表面保護層に 含有する電子写真感光体を挙げることができる。また、 電荷輸送層及び表面保護層の少なくとも1層中に電荷輸 送材料として上記一般式(1)で示されるシラン化合物 を含み、且つ電荷発生層中に電荷発生材料としてフタロ シアニン化合物結晶を含む電子写真感光体を好ましいも のとしてあげることができる。さらに好ましいものとし て、電荷輸送層中に電荷輸送材料としてヒドラゾン系化 合物やスチルベン系化合物等の公知の電荷輸送材料を含 み、電荷発生層中に電荷発生材料としてフタロシアニン 化合物結晶を含み、且つ表面保護層に上記一般式(1)

のシラン化合物を含む電子写真感光体を挙げることがで きる。

【0054】また、本発明に用いるフッ素含有化合物としてはフッ素含有ポリマー、フッ素含有エーテルのような様々な物質を用いることを高いてきる。なかでも、フッ素含有エステルは表面潤滑性を高めるとともに、塗布液の貯蔵安定性をも高めるれた、フッ素含有アミン、フッ素含有力に、変布液の貯蔵等は一般式(I)で表される化がさせる際の地でもなるため好ましい。また、フッま含有アルコールのもがと化学結合を形成して変にが、これる化ので更に好ましい。で表される化フッととので動は一般式(I)で表される化フッととので動したが成しているので特に好ました。なり強固な化学結合を形成しうるので特に好ました。

【〇〇55】以下に、それらのフッ素含有化合物の具体例を挙げる。フッ素含有ポリマーとしては、PTFE(4フッ化エチレン樹脂)、FEP(4フッ化エチレンー6フッ化エチレン共重合樹脂)、PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)、PVF(フッ化ビニル樹脂)、PFA(4フッ化エチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂)、PVdF(フッ化ビニリデン樹脂)、ETFE(4フッ化エチレンーエチレン共重合樹脂)、ECTFE(エチレンー3フッ化塩化エチレン共重合樹脂)等を挙げることができる。

【0056】フッ素含有シラン化合物としては、ビス (ペンタフルオロフェニル) ジメチルシラン、ビス (トリデカフルオロー1、1、2、2、一テトラヒドロオクチル) テトラメチルジシロキサン、1、3ービス (3、3、3ートリフルオロプロピリ) テトラメチルジシラザン、ジメチルジフルオロシラン、ジフェニルジフルオロシラン、メチルトリフルオロシラン、NーメチルーNートリメチルシリルトリフルオロアセトアミド等が挙げられる。

【0057】フッ素含有エーテルとしては、2、2、2 ートリフルオロエチルメチルエーテル、2、2、2ート リフルオロエチルジフルオロメチルエーテル、1、1、 2, 2ーテトラフルオロエチルメチルエーテル、2, 2. 3. 3. 3ーペンタフルオロプロピルメチルエーテ ル、2、2、3、3、3ーペンタフルオロプロピルジフ ルオロメチルエーテル、1、1、2、2ーテトラフルオ ロエチルエーテル、1、1、2、2ーテトラフルオロエ チル2、2、2ートリフルオロエチルエーテル、2、 2、3、3ーテトラフルオロプロピルジフルオロメチル エーテル、ヘキサフルオロイソプロピルメチルエーテ ル、ヘキサフルオロイソプロピルジフルオロメチルエー テル、1、1、2、3、3、3-ヘキサフルオロプロピ ルメチルエーテル、2、2、3、3、3ーペンタフルオ ロプロピル1、1、2、2ーテトラフルオロエチルエー テル、1、1、3、3、3ーペンタフルオロー2ートリ フルオロメチルプロピルメチルエーテル、1、1、2、 3. 3. 3-ヘキサフルオロプロピルエチルエーテル、 2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチルジフル オロメチルエーテル等を挙げることができる。

【0058】フッ素含有エステルとしては、メチルパーフルオロプロピオネート、エチルパーフルオロプロピオネート、エチルパーフルオロプロピオネート、メチルパーフルオロブチレート、エチルー5ーヒドロキシオクタフルオロヘプタン酸、エチルパーフルオロオクタノエート、エチルパーフルオロオクタノエート等を挙げることができる。

【0059】フッ素含有アミンとしては1、1ージヒドローへプタフルオロブチルアミン、1、1ージヒドローペンタデカフルオロブチルアミン等を挙げることができる。

【0060】フッ素含有カルボン酸としてはトリフルオロ酢酸、パーフルオロプロパン酸、パーフルオロブタン酸、パーフルオロヘキサン酸、パーフルオロヘフタン酸、パーフルオロオクタン酸、パーフルオロノナン酸、パーフルオロウンデカン酸、パーフルオロウンデカン酸、等を挙げることができる。

【0061】フッ素含有アルコールとしては2、2、2 ートリフルオロエタノール、2ーフルオロエタノール、 2、2、3、3、3ーペンタフルオロプロパノール、 1、1、3ートリヒドロテトラフルオロペンタノール、 2ーヒドローヘキサフルオロー2ープロパノール、1、 1. 3-トリヒドロヘキサフルオロブタノール、1. 1, 5-トリヒドロテトラフルオロペンタノール、2, 2ービス(トリフルオロメチル)プロパノール、2ー (パーフルオロブチル) エタノール、2ーパーフルオロ プロポキシー2、3、3、3ーテトラフルオロプロパノ ール、3ーパーフルオロブチルー2ーヨードプロパノー ル、2-(パーフルオロー3-メチルブチル)エタノー ル、1、1、7ートリヒドロドデカフルオロヘプタノー ル、6-(パーフルオロエチル)へキサノール、1、1 ージヒドロヘプタフルオロブタノール、2ー(パーフル オロヘキシル) エタノール、3ー (パーフルオロヘキシ ル) プロパノール、3ーパーフルオロヘキシルー2ーヨ ―ドプロパノール、6-(パーフルオロー1ーメチルエ チル) ヘキサノール、2-(パーフルオロー5-メチル ヘキシル) エタノール、1、1、9トリヒドロヘキサデ カフルオロノナノール、6-(パーフルオロブチル)へ キサノール、2ー(パーフルオロオクチル)エタノー ル、3-(パーフルオロー5-メチルヘキシル)-2-ヨードプロパノール、3-(パーフルオロオクチル)プ ロパノール、3-パーフルオロオクチルー2-ヨードプ ロパノール、6-(パーフルオロー3-メチルブチル) ヘキサノール、2-(パーフルオローフーメチルオクチ ル) エタノール、6-(パーフルオロヘキシル) ヘキサ ノール、2-(パーフルオロデシル)エタノール、3-(パーフルオローフーメチルオクチル) ー2ーヨードプ ロパノール、6-(パーフルオロー5-メチルヘキシ ル) ヘキサノール、2-(パーフルオロー9ーメチルデ シル) エタノール、6ー (パーフルオロオクチル) ヘキ サノール、6-(パーフルオローフーメチルデシル)エ タノール等を挙げることができる。

【0062】フッ素含有オレフィンとしては1ーメトキシー(パーフルオロー2ーメチルー1ープロペン)、パーフルオロブチルエチレン、パーフルオロへキシルエチレン、1、4ージビニルオクタフルオロブタン、パーフルオロオクチルエチレン、1、6ージビニルドデカエフルオロヘキサン、パーフルオロデシルエチレン、1、8ージビニルへキサデカエフルオロオクタン、パーフルオロデシルエチレン等を挙げることができる。

【0063】フッ素含有シランカップリング材として は、3、3、4、4、5、5、6、6、6ーノナフルオ ロヘキシルメチルジクロロシラン、3、3、4、4、 5, 5, 6, 6, 6ーノナフルオロヘキシルトリクロロ シラン、ペンタフルオロプロピルトリクロロシラン、ペ ンタフルオロプロピルトリメトキシシラン、(トリデカ フルオロー1、1、2、2ーテトラヒドロオクチル)ジ メチルクロロシラン、(トリデカフルオロー1、1、 2. 2ーテトラヒドロオクチル) メチルジクロロシラ ン、(トリデカフルオロー1、1、2、2ーテトラヒド ロオクチル)トリクロロシラン、(トリデカフルオロー 1、1、2、2ーテトラヒドロオクチル)トリメトキシ シラン、(トリデカフルオロー1、1、2、2ーテトラ ヒドロオクチル) トリエトキシシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)ジメチルクロロシラン、(3. 3. 3-トリフルオロプロピル) メチルジクロロシラ ン、(3,3,3-トリフルオロプロピル)トリクロロ シラン、(3、3、3ートリフルオロプロピル)トリメ トキシシラン、(ヘプタデカフルオロー1、1、2、 2, ーテトラヒドロデシル) ジメチルクロロシラン、 (ヘプタデカフルオロー1、1、2、2、一テトラヒド ロデシル)トリクロロシラン、(ヘプタデカフルオロー 1. 1, 2, 2, ーテトラヒドロデシル) トリエトキシ シラン、(ヘプタデカフルオロー1、1、2、2、一テ トラヒドロデシル)トリメトキシシラン、(3ーヘプタ フルオロイソプロポキシ) プロピルトリクロロシラン、 (3-ヘプタフルオロイソプロポキシ) プロピルトリエ トキシシラン、トリエトキシフルオロシラン、3ートリ フルオロアセトキシプロピルトリメトキシシラン等が挙 げられる。

【0064】電子写真感光体において本発明の上記一般 式(I)で示される化合物および、さらに、フッ素含有 化合物を用いることにより、強固かつ低表面エネルギー の表面層を持つ耐久性の優れた電子写真感光体を作成す ることが可能である。電荷発生材料や電荷輸送材料とし ては公知のいかなる材料も用いることができる。中でも 電荷発生材料としてフタロシアニン化合物結晶を含み、 感光層中に、一般式(1)で表される化合物を単独ある いはヒドラゾン系化合物やスチルベン系化合物等の公知 の電荷輸送材料と混合したものとフッ素含有化合物を含 む電子写真感光体が感度、安定性の点から好ましい。更 に、電荷発生材料として、フタロシアニン化合物結晶を 含み、感光層中に電荷輸送材料として、ヒドラゾン系化 合物やスチルベン系化合物等の公知の電荷輸送材料を用 いてポリカーボネートやポリエステルなどの公知のバイ ンダーと共に電荷輸送層を形成し、更にこの電荷輸送層 上に一般式(I)で表される化合物とフッ素含有化合物 とを含有する保護層を形成した電子写真感光体を挙げる ことができる。

【0065】本発明における上記電子写真感光体におい

て、一般式(I)で示される化合物およびフッ素含有化合物と組み合せて使用されるフタロシアニン結晶としては、特開平5-98181号公報に開示されているハロゲン化ガリウムフタロシアニン結晶、特開平5-140473号公報と開来5-140473号公報に開示されているハロゲン化スズフタロシアニン結晶、特開平5-279591号公報に開示されているヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶、特開平4-189873号公報及び特開平5-43813号公報に開示されているオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶を用いることができ、それにより、特に高感度で、繰り返し安定性の優れた電子写真感光体を得ることができる。

【0066】次に、電子写真感光体について説明する。 電子写真感光体は単層構成、電荷発生層と電荷輸送層と からなる積層構成、更に、これらの上に表面保護層を設 けた構成などいかなる構成でもよい。一般式 (I) で示 される化合物とフッソ含有化合物はこれらのいかなる層 に含まれていてもよいが、最表面層に含まれる場合が最 も効果的である。

【0067】これらの電荷発生層と電荷輸送層等が形成 される基材となる導電性支持体としては、アルミニウ ム、ニッケル、クロム、ステンレス鋼等の金属類、およ びアルミニウム、チタニウム、ニッケル、クロム、ステ ンレス鋼、金、バナジウム、酸化錫、酸化インジウム、 ITO等の薄膜を設けたプラスチックフィルム等、ある いは導電性付与剤を塗布、または、含浸させた紙、およ びプラスチックフィルム等があげられる。これらの導電 性支持体は、ドラム状、シート状、プレート状等、適宜 の形状のものとして使用されるが、これらに限定される ものではない。さらに必要に応じて導電性支持体の表面 は、画質に影響のない範囲で各種の処理を行うことがで きる。例えば、表面の酸化処理や薬品処理、及び、着色 処理等または、砂目立てなどの乱反射処理等を行うこと ができる。また、導電性支持体と電荷発生層の間にさら に下引層を設けてもよい。この下引層は積層構造からな る感光層の帯電時において、導電性支持体から感光層へ の電荷の注入を阻止するとともに、感光層を導電性支持 体に対して一体的に接着保持せしめる接着層としての作 用、あるいは場合によっては導電性支持体の光の反射防 止作用等を示す。

【0068】この下引層に用いるバインダーポリマーは、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリアミド樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリイミド樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、ニトロセルロース、カゼイン、ゼラチン、ポリグルタミン酸、澱粉、スターチアセテー

ト、アミノ澱粉、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ジルコニウムキレート化合物、チタニウムキレート化合物、有機チタニウム化合物、シランカップリング剤等の公知の材料を用いることができる。また、下引層の厚みは 0.01~10μm、好ましくは 0.05~2μmが適当である。さらに下引層を設ける際の塗布方法としては、ブレードコーティング法、ワイヤーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の方法を用いることができる。

【0069】積層構成の場合、この下引き層のうえに電荷発生層と電荷輸送層とが形成される。

【0070】まず、電荷発生層について説明する。電荷発生層は電荷発生材料が好適なパインダーポリマー(結着樹脂)に分散されて形成されるが、電荷発生層に含まれる電荷発生材料としては、下記のフタロシアニン結晶、ビスアゾ顔料、フタロシアニン顔料、スクアリリウム顔料、ペリレン顔料、ジブロモアントアントロン等のいかなる公知の電荷発生材料も使用することができる。この中では、フタロシアニン結晶が好ましく用いられる。

【0071】電荷発生材料として好適に用いられるフタロシアニン結晶には、特開平5-98181号公報に開示されているハロゲン化ガリウムフタロシアニン結晶、特開平5-140473号公報に開示されているハロゲン化スズフタロシアニン結晶、特開平5-263007号公報及び特開平5-279591号公報に開示されているヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶、特開平4-189873号公報及び特開平5-43813号公報に開示されているオキシチタニウムフタロシアニン水和物結晶があり、これにより、特に高感度で、繰り返し安定性に優れた電子写真感光体を得ることができる。

【0072】本発明に使用可能なハロゲン化ガリウムフ タロシアニン結晶として、クロロガリウムフタロシアニ ン結晶を挙げることができ、クロロガリウムフタロシア 二ン結晶は、特開平5一98181号公報に開示されて いるように、公知の方法で製造されるクロロガリウムフ タロシアニン結晶を、自動乳鉢、遊星ミル、振動ミル、 CFミル、ローラーミル、サンドミル、ニーダー等で機 械的に乾式粉砕するか、乾式粉砕後、溶剤と共にボール ミル、乳鉢、サンドミル、ニーダー等を用いて湿式粉砕 処理を行うことによって製造することができる。上記の 処理において使用可能な溶剤には、トルエン及びクロロ ベンゼン等のような芳香族類;ジメチルホルムアミド及 びN-メチルピロリドン等のようなアミド類:メタノー ル、エタノール及びブタノール等のような脂肪族アルコ ール類: エチレングリコール、グリセリン及びポリエチ レングリコール等のような脂肪族多価アルコール類:ベ

ンジルアルコール及びフェネチルアルコール等のような 芳香族アルコール類: 酢酸エステル及び酢酸ブチルケトン類: アセトン及びメチルエチルケトン類: ジメチルスルホキシド: ジエテル類 ーテル及びテトラヒドロフラン等のようなエーテル類で ーテル及びテトラヒドロフラン等のようなエーテル類で これらの混合物: 水とこれら有機溶剤との混合物が挙 品で 100重量部、グロロガリウムフタロシアニンは10~100重量部の範囲で用いる。また、処理温度は、0°C~溶剤の沸点以下、好ましくは10~60°Cである。さらに、粉砕の際に食塩、ぼう硝等の磨砕助剤ロンタロシアニン結晶の重量の0.5~20倍、好ましくは1~10倍で用いることができる。

【0073】本発明に使用可能なハロゲン化スズフタロシアニン結晶として、ジクロロスズフタロシアニン結晶を挙げることができ、ジクロロスズフタロシアニン結晶は、特開平5-140472号公報及び特開平5-140473号公報に開示されているように、公知の方法で製造されるジクロロスズフタロシアニン結晶を、前記のクロロガリウムフタロシアニンと同様に粉砕し、溶剤処理することにより得ることができる。

【0074】本発明に使用可能なヒドロキシガリウムフ タロシアニン結晶は、特開平5-263007号公報及 び特開平5-279591号公報に開示されているよう に、公知の方法で製造されたクロロガリウムフタロシア ニン結晶に、酸若しくはアルカリ性溶液中での加水分解 又はアシッドペースティングを行って、ヒドロキシガリ ウムフタロシアニン結晶を合成し、次いで直接溶剤処理 を行うか、又は、合成によって得られたヒドロキシガリ ウムフタロシアニン結晶を溶剤と共にボールミル、乳 鉢、サンドミル、ニーダー等を用いて湿式粉砕処理を行 うか、溶剤を用いずに乾式粉砕処理を行った後に溶剤処 理することによって製造することができる。上記の処理 において使用可能な溶剤としては、前記のクロロガリウ ムフタロシアニン結晶の製造における湿式粉砕処理で使 用可能な溶剤を使用することができる。溶剤は、ヒドロ キシガリウムフタロシアニン結晶1重量部に対して、1 ~200重量部、好ましくは10~100重量部の範囲 で用いる。また、処理温度は、O~150°C、好まし くは室温~100°Cである。さらに、粉砕の際に食 塩、ぼう硝等の磨砕助剤を用いることもできる。磨砕助 剤はヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の重量の 0. 5~20倍、好ましくは1~10倍で用いることが できる。

【0075】本発明に使用可能なオキシチタニウムフタロシアニン結晶は、特開平4-189873号公報及び特開平5-43813号公報に開示されているように、公知の方法で製造されるオキシチタニウムフタロシアニン結晶を、アシッドペースティングするか、又は、ボー

ルミル、乳鉢、サンドミル、ニーダー等を用いて無機塩 と共にソルトミリングを行って、X線回折スペクトルに おいて27.2°にピークを持つ、比較的結晶性の低い オキシチタニウムフタロシアニン結晶とした後、直接溶 剤処理を行うか、又は、溶剤と共に、ボールミル、乳 鉢、サンドミル、ニーダー等を用いて湿式粉砕処理を行 うことによって製造することができる。アシッドペース ティングに使用可能な酸としては、硫酸が好ましく、濃 度70~100%、好ましくは95~100%のものが 使用され、溶解温度は、-20~100°C、好ましく はO~60°Cである。使用される濃硫酸の量は、オキ シチタニウムフタロシアニン結晶の重量の1~100 倍、好ましくは3~50倍である。アシッドペーティン グで使用可能な溶剤としては、水、又は、水と有機溶剤 との混合溶剤が任意の量で用いられ、水と、メタノー ル、エタノール等のアルコール系溶剤との混合物、又 は、水と、ベンゼン、トルエン等の芳香族系溶剤との混 合溶剤が特に好ましい。析出させる温度については特に 制限はないが、発熱を防ぐために、氷等で冷却すること が好ましい。また、オキシチタニウムフタロシアニン結 晶と無機塩との混合比(重量比)は、1/0.1~1/ 20、好ましくは1/0.5~1/5である。上記の溶 剤処理において使用される溶剤としては、トルエン及び クロロベンゼン等のような芳香族類:メタノール、エタ ノール及びブタノール等のような脂肪族アルコール類: ジクロロメタン、クロロホルム及びトリクロロエタン等 のようなハロゲン系炭化水素類;これらの混合物:水と これら有機溶剤との混合物等が挙げられる。溶剤処理に おける溶剤は、オキシチタニウムフタロシアニン結晶の 重量の1~100倍、好ましくは5~50倍の範囲で用 いる。また、処理温度は、室温~100°C、好ましく は50~100°Cである。さらに、粉砕の際に食塩、 ぼう硝等の磨砕助剤を用いることもできる。磨砕助剤は オキシチタニウムフタロシアニン結晶の重量の0.5~ 20倍、好ましくは1~10倍で用いることができる。 【0076】電荷発生層に用いるパインダーポリマーと しては、広範な絶縁性樹脂から選択することができる。 また、ポリーN-ビニルカルバゾール、ポリビニルアン トラセン、ポリビニルピレン、ポリシランなどの有機光 導電性ポリマーから選択することもできる。好ましいバ インダーポリマーとしては、ポリビニルブチラール樹 脂、ポリアリレート樹脂(ビスフェノールAとフタル酸 の重縮合体等)、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル 樹脂、フェノキシ樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合 体、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、ポリアクリルアミ ド樹脂、ポリビニルピリジン樹脂、セルロース樹脂、ウ レタン樹脂、エポキシ樹脂、カゼイン、ポリビニルアル コール樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂等の絶縁性樹脂 を挙げることができるが、これらに限定されるものでは ない。これらのバインダーポリマーは単独で用いても、

2種以上混合して用いてもよい。

【0077】また、電荷発生材料とバインダーポリマーとの配合比(重量比)は、10:1~1:10の範囲が好ましい。また、バインダーポリマー中に電荷発生材料を分散させる方法としては、ボールミル分散法、アトライター分散法、サンドミル分散法等の通常の方法を用いることができる。

【0078】さらに、この分散の際、粒子サイズを、0.5μm以下、好ましくは0.3μm以下、さらに好ましくは0.15μm以下にすることが有効である。また、これらの分散に用いる溶剤としては、メタノール、エタノール、nープロパノール、nーブタノール、ベンジルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸 n ーブチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム、クロルベンゼン、トルエン等の通常の有機溶剤を単独又は2種以上混合して用いることができる。

【0079】なお、電荷発生層は電荷輸送層上に形成してもよいし、また、下引層と電荷輸送層との間に形成してもよい。

【〇〇80】電荷輸送層は一般式(I)で示されるシラン化合物を単独で用いてもよく、さらに、フッ素含有化合物を併用してもよい。また、シラン化合物及び所望により併用されるフッ素含有化合物とともにこれらと相溶可能な材料を用いてもよく、例えば、公知のパインダーポリマ中に分散させて用いてもよい。また、それを硬化させて用いてもよい。また、一般式(I)で示されるシラン化合物(/フッ素含有化合物)と、ヒドラゾン系電荷輸送材料、トリアリールアミン系電荷輸送材料又はスチルベン系電荷輸送材料と、電荷輸送性ポリマーとを混合して用いてもよく、さらにそれを硬化させて用いてもよい。

【0081】また、一般式(1)で示されるシラン化合物の代わりに、ヒドラゾン系電荷輸送材料、トリアリールアミン系電荷輸送材料又はスチルベン系電荷輸送材料と、電荷輸送性ポリマーとを混合して用いてもよく、さらにそれを硬化させて用いてもよい。

【 O O 8 2 】電荷輸送層に使用されるバインダーポリマーとしては、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ ビニルアセテート樹脂、スチレンーブタジエン共重合体、塩化ビニリデンーアクリロニトリル共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニル共産合体、シリコン樹脂、シリコンーアルキッド樹脂、フェノールーホルムアルデヒド樹脂、フェノールーホルムアルデヒド樹脂、スチレンーアルキッド樹脂等の絶縁性樹脂、ポリートリビニルカルバゾール、ポリシラン等の導電性樹脂を用いることができるがこれらに限定されるものではない。こ

れらのバインダーポリマーのうち、相溶性、成膜性等の 点から、下記構造式 (II) ~ (VI) で示されるポリ カーボネート樹脂、又はそれらを共重合させたポリカー ボネート樹脂がより好ましい。

[0083]

【化12】

$$-+ \circ - \bigcirc - \circ - \circ \xrightarrow{\rho} - \circ - \circ \xrightarrow{\rho} + (\text{IV})$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
\hline
 & CH_3$$

$$+ \circ - \bigcirc - \circ - \circ \xrightarrow{\circ} \xrightarrow{}_{n} (VI)$$

【0084】上記構造式中、nは重合度を表し、具体的には50~3000の整数を示す。一般式(I)で表されるシラン化合物と他の電荷輸送材料を混合させて用いる場合の配合比(重量比)は100/1 ~1/100、好ましくは90/10~10/90、さらに好ましくは60/40~40/60である。さらに、これらをパインダーポリマーと混合させる場合には、一般式

(1)で表されるシラン化合物及び他の電荷輸送材料の和と結着樹脂との配合比(重量比)は100/1~1/100、好ましくは80/20~50/50である。

【 O O 8 5 】また、電荷輸送材料やバインダーポリマー 以外にもシラン化合物やフッ素含有化合物と相溶可能な 添加剤を添加してもよい。

【0086】硬化反応を行う場合には、無触媒で行っても、適切な触媒を用いてもよい。硬化反応で用いられる触媒としては以下のようなものが挙げられる。塩酸、硫酸、蟻酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、等の酸触媒、アンモニア、トリエチルアミン等の塩基、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジオクトエート、オクエ酸第一錫等の有機錫化合物、テトラーnーブチルチタネート、テトライソプロピルチタネート等の有機チタン化合物、有機

カルボン酸の鉄塩、マンガン塩、コバルト塩、亜鉛塩、 ジルコニウム塩等が挙げられる。

【0087】更に、本発明に用いられる化合物の中で骨格中に炭素一炭素不飽和結合を持つものの硬化反応については、触媒としてH2 PtCl $6\cdot6H2$  O、RhCl(PPh3) 3、I rCl(CO)(PPh3) 2、Co2(CO)8、Pt(C2H4)(PPh3) 2、[Pt(C2H4)Cl2] 2等の公知のヒドロシリル化触媒を単独、あるいは前記の触媒と混合して用いることもできる。 また、硬化反応の際の温度、湿度は特に制限はないが、室温~ $150^\circ$  C、40~100%に設定することが望ましい。

【0088】この電荷輸送層を設ける際の塗布方法としては、ブレードコーティング法、ワイヤーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の方法を用いることができる。

【0089】また、電荷輸送層の厚さは5~50 µm、 好ましくは10~30μmである。また通常の電荷輸送 材料とパインダーからなる電荷輸送層上に更に保護層を 形成する場合には、本発明の一般式(1)で表される化 合物およびフッソ含有化合物を硬化させて用いることが できる。この際の電荷輸送層としては電荷輸送材料とバ インダーを重量比で10/90~70/30、好ましく は20/80~60/40で形成する。また、保護層に は必要に応じ、アルミニウム系カップリング材、シラン 系カップリング材、チタネート系カップリング材等のカ ップリング材、あるいはコロイダルシリカなどの微粒子 あるいは前記の電荷輸送層や、電荷発生層に用いたよう な一般的な結着樹脂、市販のハードコート材を混合して もよい。本発明の一般式(I)で表される化合物および フッソ含有化合物と他の材料を混合させて用いる際には その比率は重量比で100/1 ~1/100好ましく は、90/10~10/90更に好ましくは、70/3 0~20/80で用いられる。

【0090】また、表面保護層で使用可能なカップリング剤としてはアセトキシアルミニウムジイソプロピレート、アセトエトキシアルミニウムジイソプロピレート等では、アセトプロポキシアルミニウムジイソプロピレート等のアルミニウム系カップリング材やチタンn-グリンドキシンカーグリンドキシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリシドキシフロピルトリメトキシシテン、アーブロピルトリエトキシシテン、アーアミノプロピルトリエトキシシテン、アーアミノプロピルトリエトキシシテン、テトラチル)アーアミノプロピルトリエトキシシラン、テトラ

メトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン等のシラン系カップリング材等の各種カップリング材を用いることができる。また、市販のハードコート材としては、KP-85 (信越シリコーン社製)、X-40-9740 (信越シリコーン社製)、X-40-9740 (信越シリコーン社製)、X-41-1007 (信越シリコーン社製)、KNS-5300 (信越シリコーン社製)、KNS-5300 (信越シリコーン社製)、A-40-2239 (信越シリコーン社製)、AY42-440 (東レダウコーニングシリコーン社製)、AY42-441 (東レダウコーニングシリコーン社製)、AY49-208 (東レダウコーニングシリコーン社製)、AY49-208 (東レダウコーニングシリコーン社製)等のハードコート材を用いることができる。

【0091】保護層の形成に使用する溶剤としては保護層を形成する材料を溶解しかつ、下層の電荷輸送層を犯さない溶剤が好ましく、例えばエタノール、ブタノールシクロヘキサノール等のアルコール類、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル等のエーテル類、キシレン、ローシメン等の芳香族系溶剤、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ等のセルソルブ類が挙げられ、中でも特にジブチルエーテルが強固で均一な膜が得られるため好ましい。

【0092】保護層の硬化反応は前記電荷輸送層を硬化 する場合と同様に行うことができる。

【0093】また、保護層の厚さは $0.1\sim10\mu$ m、好ましくは $0.5\sim7\mu$ m、更に好ましくは $1\sim5\mu$ m で用いられる。この保護層を設ける際の塗布方法としては、ブレードコーティング法、マイヤーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の方法を用いることができる。

【0094】電子写真感光体が単層構成の場合には、一般式(I)で表される化合物、フッ素含有化合物および電荷発生材を所望の比率で混合して用いる。必要により前記の公知の電荷輸送材、公知のバインダー、カップリング剤、酸化防止剤、硬化触媒等を混合し、用いることができるが、添加する材料も一般式(I)で表される化合物およびフッ素化合物と結合可能な物が好ましく、特に一〇一Si一〇一結合を形成する物が強固な膜が得られ、好ましい。

【0095】一般式(I)で表される化合物:フッ素含有化合物の比率は99:1~40:60で用いられ、好ましくは95:5~50:50さらに好ましくは90:10~40:60で用いられる。更に他の材料を混合する場合には一般式(I)で表される化合物およびフッ素含有化合物および電荷発生材料:他の材料の比率は99:1~40:60で用いられ、好ましくは95:5~45:55、さらに好ましくは90:10~50:50

で用いられる。

【0096】膜の厚さは5~50μm、好ましくは10~40μmが適当である。更に、この単層の電子写真感光体の塗布方法としては、ブレードコーティング法、マイヤーパーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常の方法を用いることができる。塗布に使用する溶剤としては、テトラヒドロフラン、クロロベンゼン、トルエン、塩化メチレン、クロロホルム、シクロヘキサノン等の通常の溶剤を単独あるいは2種以上混合して用いることができる。

【0097】更に、上記の層を加熱、調湿等の手段により硬化させることも可能である。この際、用いるフッソ含有化合物としてはフッソ含有シラン化合物、フッソ含有アルコール、フッソ含有オレフィン等が好ましく、特にフッソ含有シラン化合物が好ましい。また、パインダーとしては化学反応により一〇一Si一〇一結合を形成できる物が特に好ましい。

[8000]

【実施例】以下、実施例によって本発明を詳細に説明する。

【0099】(合成例1)

ーシラン化合物(1)の合成ー

窒素置換したニロフラスコに3ーヨードプロピルトリメトキシシラン25gを入れ、トルエン200mlに溶解させた。次いで、トリフェニルホスフィン27gを加えた。その後、撹拌しながら、7時間加熱還流した後析出した結晶をトルエンでよく洗い減圧下溶媒を除去し、白色結晶のホスホニウム塩36.5グラムを得た。得られたホスホニウム塩の融点は102.0~102.5°Cであった。

【0100】窒素置換した二ロフラスコにホスホニウム塩15gを入れ、無水ジメチルホルムアミド300mlに溶解させた。次いで、反応系を-5°Cに冷却し、水素化ナトリウム1.05gを加え、15分撹拌した。その後、撹拌しながら、Nー(4ーホルミルフェニル)ーハー(3、4ージメチルフェニル)ビフェニルー4ーアミン5.1gを加え、徐々に室温まで温度を上げ、2時間撹拌した。反応終了後、メタノール10mlを加え、さらに反応混合物を3リットルの氷水中に注ぎトルエンで抽出し減圧下溶媒を除去した後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:トルエン)し、淡黄色の油状のシラン化合物(1)6gを得た。得られたシラン化合物の1尺吸収スペクトルを図1に示す。

【0101】(合成例2)

ーシラン化合物(12)の合成ー

窒素置換したニロフラスコに実施例1で合成したホスホニウム塩15.9gを入れ、無水ジメチルホルムアミド300mlに溶解させた。次いで、反応系を-5°Cに

冷却し、水素化ナトリウム 1. 5gを加え、15分撹拌した。その後、撹拌しながら、3、3′ージメチルーN、N′ービス(4ーホルミルフェニル)ーN、N′ービス(3、4ージメチルフェニル)ー1、1′ービス(3、4ージメチルフェニル)ー1、1′ービス になる。反応終了後、メタにはまで温度を上げ、2時間撹拌した。反応終了後、メタール30m」を加え、さらに反応混合物を3リットルの氷水中に注ぎトルエンで抽出し減圧下溶媒を除去した後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:トルエン)し、淡黄色の油状のシラン化合物(12)6.9gを得た。得られたシラン化合物の1尺吸収スペクトルを図2に示す。

【0102】(合成例3)

ーシラン化合物(4)の合成ー

窒素置換したニロフラスコにNー(4ーホルミルフェニル)ーNー(3、4ージメチルフェニル)ビフェニルー4ーアミン10gを入れ、トルエン100mlに溶解させた。次いで、モレキュラーシーブ4A1gとパラトルエンスルホン酸0.5gを加えた。その後撹拌しながら、3ーアミノプロピルトリメトキシシラン13gを10分かけて滴下し、室温で5時間撹拌した後、200mlの水に注ぎトルエンで抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させ減圧下溶媒を留去し、淡黄色の油状のシラン化合物(4)13.2gを得た。得られたシラン化合物の1R吸収スペクトルを図3に示す。

【0103】(合成例4)

ーシラン化合物(5)の合成ー

窒素置換したニロフラスコにNー(4ーホルミルフェニル)ーNー(3、4ージメチルフェニル)ビフェニルー4ーアミン10gを入れ、トルエン100mlに溶解させた。次いで、モレキュラーシーブ4A1gとパラトルエンスルホン酸0.5gを加えた。その後撹拌しながら、3ーアミノプロピルトリエトキシシラン13gを10分かけて滴下し、室温で5時間撹拌した後、200mlの水に注ぎトルエンで抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させ減圧下溶媒を留去し、淡黄色の油状のシラン化合物(5)13gを得た。得られたシラン化合物の1R吸収スペクトルを図4に示す。

【0104】(合成例5)

ーシラン化合物(15)の合成ー

窒素置換したニロフラスコに3、3'ージメチルーN、N'ービス(4ーホルミルフェニル)ーN、N'ービス(3、4ージメチルフェニル)ー1、1'ービフェニルー4、4'ージアミン10gを入れ、トルエン100m Iに溶解させた。次いで、モレキュラーシーブ4A1gとパラトルエンスルホン酸1gを加えた。その後撹拌しながら、3ーアミノプロピルトリメトキシシラン12gを10分かけて滴下し、室温で5時間撹拌した後、200mIの水に注ぎトルエンで抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させ減圧下溶媒を留去し、淡黄色の

油状のシラン化合物(15)11gを得た。得られたシラン化合物のIR吸収スペクトルを図5に示す。

【0105】(合成例6)

ーシラン化合物(16)の合成ー

窒素置換したニロフラスコに3、3、一ジメチルーN、N、一ビス(4ーホルミルフェニル)ーN、N、一ビス(3、4ージメチルフェニル)ー1、1、一ビフェニルー4、4、一ジアミン10gを入れ、トルエン100m」に溶解させた。次いで、モレキュラーシーブ4A1gとパラトルエンスルホン酸1gを加えた。その後撹拌しながら、3ーアミノプロピルトリエトキシシラン15gを10分かけて滴下し、室温で5時間撹拌した後、200m」の水に注ぎトルエンで抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させ減圧下溶媒を留去し、淡黄色の油状のシラン化合物(16)12gを得た。得られたシラン化合物のIR吸収スペクトルを図6に示す。

【0106】(合成例7)

ーシラン化合物(6)の合成ー

ナス型フラスコに合成例1で製造したシラン化合物

(1) 6gを入れ、テトラヒドロフラン20mlとエタノール20mlとの混合物に溶解させた。次いで、5%Pd-C0、1gを加え、乾燥水素で置換し、フラスコの口を乾燥水素供給源に接続した状態で、15時間室温で反応させた。反応終了後、Pd-Cをろ過し、減圧下溶媒を除去した後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:トルエン)し、淡黄色の油状のシラン化合物(6)4.2gを得た。得られたシラン化合物のIR吸収スペクトルを図7に示す。

【0107】(合成例8)

ーシラン化合物(17)の合成一

ナス型フラスコに合成例2で製造したシラン化合物(12)6.3gを入れ、テトラヒドロフラン20mlとエタノール20mlとの混合物に溶解させた。次いで、5%Pd-C0.2gを加え、乾燥水素で置換し、フラスコの口を乾燥水素供給源に接続した状態で、15時間室温で反応させた。反応終了後、Pd-Cをろ過し、減圧下溶媒を除去した後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=1/1)し、淡黄色の油状のシラン化合物(17)5.9gを得た。得られたシラン化合物の1R吸収スペクトルを図8に示す。

【0108】(合成例9)

- クロロガリウムフタロシアニン結晶の合成-

1.3ージイミノイソインドリン30重量部、3塩化ガリウム9.1重量部をキノリン230重量部中に入れ、200°Cにおいて3時間反応させた後、生成物(湿ケーキ)をろ別し、アセトン、メタノールで洗浄し、次いで、湿ケーキを乾燥した後、クロロガリウムフタロシアニン結晶28重量部を得た。得られたクロロガリウムフタロシアニン結晶3重量部を、自動乳鉢(LabーMillUT-21型、ヤマト科学社製)で3時間乾式粉

## 【0109】(合成例10)

ージクロロスズフタロシアニン結晶の合成一 フタロニトリル50g及び無水塩化第2スズ27gを、 1-クロルナフタレン350ml中に加え、195°C において5時間反応させた後、生成物をろ別し、1-ク ロルナフタレン、アセトン、メタノール、次いで水で洗 浄した後、減圧乾燥して、ジクロロスズフタロシアニン 結晶18.3gを得た。得られたジクロロスズフタロシ アニン結晶5gを、食塩10g、メノウボール(20m mφ)500gと共にメノウ製ポットに入れ、遊星型ボ ールミル (Pー5型、フリッチュ社製) にて400 r p mで10時間粉砕した後、十分に水洗し、乾燥した。そ のO. 5gを、テトラヒドロフラン15g、ガラスビー ズ (1 mm φ) 30gと共に室温下24時間ミリング処 理した後、ガラスビーズをろ別し、メタノールで洗浄 し、乾燥して、粉末X線回折スペクトルで $2\theta$  $\pm$ 0.2 °=8.5°、11.2°、14.5°及び27.2° に強い回折ピークを有するジクロロスズフタロシアニン 結晶(CG-2)を得た。

#### 【0110】(合成例11)

ーヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の合成ー合成例10で得られたクロロガリウムフタロシアニン結晶3重量部を濃硫酸60重量部に0°Cにて溶解した後、5°Cの蒸留水450重量部に上記溶液を滴下した後、5°Cの蒸留水450重量部に上記溶液を滴下した後、乾燥し、2.5重量部のヒドロキシガリウムシアニン結晶を得た。この結晶を自動乳鉢にて5.5時間粉砕した後、その0.5重量部をジメチルルで5.5時間粉砕した後、その0.5重量部をジメチルルで5.5時間を共に24時間ミリングし、次いで、結晶を分トルでメタノールで洗浄後乾燥し、粉末 X線回折スペクトルで洗浄を乾燥し、粉末 X線回折スペクトルで20±0.2°=7.5°、9.9°、12.5°、16.3°、18.6°、25.1°及び28.3°に強い回折ピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶(CG-3)を得た。

#### 【0111】(合成例12)

ーオキシチタニウムフタロシアニン結晶の合成ー
1、3ージイミノイソインドリン30重量部、チタニウムテトラブトキシド17重量部を1ークロルナフタレン200重量部中に入れ、窒素気流下190°Cにおいて5時間反応させた後、生成物をろ過し、アンモニア水、水、アセトンで洗浄し、オキシチタニウムフタロシアニ

ン40重量部を得た。得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶5重量部と塩化ナトリウム10重量部を料料 (Lab-MILL UT-21型、ヤマト科学社製)を用いて3時間粉砕した。その後、蒸留水で充分に洗浄し、乾燥して4.8重量部のオキシチタニウムフタロシアニン結晶を得た。得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶は、粉末X線回折スペクトルで2 $\theta$  に明瞭なピークを示すもので、3°に明瞭なピークを示すもので、60.2°=27.3°に明瞭なピークをアニン結晶を整数水20重量部、モノクロロベンゼン2重量部の混合溶剤中で、50°Cにおいて1時間撹拌したメタールで十分洗浄し、乾燥して、粉末X線回折スペクトルで2 $\theta$ +20.2°=27.3°に強計に一クを有するオキシチタニウムフタロシアニン結晶(CG-4)を得た。

#### 【O112】(実施例1)

(下引層の形成)ホーニング処理した $30mm\phi$ のアルミニウム円筒基板上にジルコニウム化合物(商品名:オルガチックス2C54O、マツモト製薬社製)100重量部、シラン化合物(商品名:A1110、日本ユンカー社製)10重量部、イソプロパノール400重量部及びブタノール200重量部からなる溶液を浸漬コーティング法で塗布し、1500 Cにおいて10分間加熱乾燥し膜厚 $0.5\mu$ mの下引層を形成した。

(電荷発生層の形成)合成例9で作製したクロロガリウムフタロシアニン結晶10重量部を、ポリビニルブチラール樹脂(商品名:エスレックBM-S、積水化学社製)10重量部及び酢酸nーブチル500重量部と混合し、ガラスビーズと共にペイントシェーカーで1時間処理して分散した後、得られた塗布液を上記下引層上に浸漬コーティング法で塗布し、100°Cにおいて10分間加熱乾燥し、膜厚0.18μmの電荷発生層を形成した。

(電荷輸送層の形成)次に、N、Nービス(3、4ージメチルフェニル)ビフェニルー4ーアミン(CTー1)2重量部と、1、1'ージー(pーフェニレン)シクロヘキサンカーボネート3重量部を、モノクロロベンゼン20重量部に溶解し、得られた塗布液を、電荷発生層が形成されたアルミニウム円筒基板上に浸漬コーティング法で塗布し、120°Cにおいて1時間加熱乾燥、膜厚15 $\mu$ mの電荷輸送層を形成した。

(表面保護層の形成) さらに、合成例1で作製したシラン化合物(1)10重量部、ハードコート剤(商品名:X-40-2239、信越シリコン社製)20重量部、フェニルトリエトキシシラン3重量部及び酢酸1重量部を混合し、得られた塗布液を、電荷輸送層が形成された上に浸漬コーティング法で塗布し、100°Cにおいて1時間加熱硬化させ、膜厚3μmの表面保護層を形成し、電子写真感光体を得た。

【0113】このようにして得られた電子写真感光体に

ついて、レーザービームプリンター(商品名: XP-11、富士ゼッロクス社製)で高温高湿(35°C、80%RH)の環境下、プリントテストを行い、1枚目と200枚コピー後の画質を評価した。その結果を表9に示す。

【0114】(実施例2~9)電荷発生材料とシラン化合物との組合せを表9のように変え、実施例1同様に電子写真感光体を作製し、評価した。結果を表9に示す。【0115】(実施例10~15)電荷輸送材料にN、N'ージフェニルーN、N'ービスー(mートリル)ベンジジン(CTー2)を用いた以外は実施例1~9と同様に電子写真感光体を作製し、評価した。結果を表9に示す。

【0116】(実施例16)実施例 $1\sim15$ と同様にアルミニウム円筒基板上に膜厚 $0.5\mu$ mの下引層を形成し、さらに電荷発生材料として合成例10で作製したクロロガリウムフタロシアニン結晶を用いた膜厚 $0.17\mu$ mの電荷発生層を形成した。

【0117】次に電荷輸送材料として合成例1で作製したシラン化合物(1)1重量部とバインダーポリマーとして構造式(II)で表されるポリカーボネート樹脂1重量部を、モロクロロベンゼン8重量部及び酢酸1重量部に溶解し、得られた塗布液を、電荷発生層が形成された上に浸漬コーティング法で塗布し、100℃において1時間加熱乾燥、硬化し、膜厚15μmの電荷輸送層を

形成した。

【0118】このようにして得られた電子写真感光体を 実施例1~15と同様に評価した。その結果を表10に 示す。

【0119】(実施例17~27)パインダーポリマー及びシラン化合物を表14のように変えた以外は、実施例16と同様に電子写真感光体を作成し、評価した。結果を表15に示す。

【0120】(比較例1)実施例 $1\sim27$ と同様にアルミニウム円筒基板上に膜厚 $0.5\mu$ mの下引層を形成し、さらに電荷輸送材料として合成例10で作製したクロロガリウムフタロシアニン結晶を用いて膜厚 $0.15\mu$ mの電荷輸送層を形成した。

【0121】次に電荷輸送材料としてトリフェニルアミン2重量部とパインダーポリマーとして構造式(II)で表されるポリカーボネート樹脂1重量部を、モロクロロベンゼン8重量部に溶解し、得られた塗布液を、電荷発生層が形成された上に浸漬コーティング法で塗布し、100℃において1時間加熱乾燥し、膜厚16μmの電荷輸送層を形成した。

【0122】このようにして得られた電子写真感光体を 実施例1~27と同様に評価した。その結果を表15に 示す。

[0123]

【表 1 4】

	化合物	電荷発生	電荷輸送		画	質	
実施例	No.	材料	材料	1枚:	ピー 後	2000枚	コピー 彼
1	(1)	CG-1	CT-1	良	纤	良	好
2	(1)	CG-2	CT-1	良	纤	良	好
3	(1)	CG-3	CT-1	良	奸	Ą	好
4_	(1)	CG-4	C1-1	良	紆	良	好
5	(4)	1-D3	CT-1	礁	纤	庚	好
6	(5)	CG-1	CT-1	良	好	廋	好
7	(13)	CG-1	CT-1	良	舒	良	好
8	(16)	CG-1	CT-1	良	舒	良	好
9	(17)	CG-1	CT-1	良	好	良	紆
10	(1)	CG-1	CT-2	艮	好	良	好
11	(4)	CG-1	CT-2	良	好	良	好
12	(5)	CG-1	CT-2	良	好	良	纤
13	(13)	CG-1	CT-2	良	蚜	良	釨
14	(16)	CG-1	CT-2	良	紆	庚	好
15	(17)	CG-1	CT-2	良	纤	良	好

【0124】 【表15】

9と同様に電子写真感光体を作製し、評価した。結果を

【0126】(比較例2)実施例と同様にアルミニウム 円筒基盤上に膜厚O. 5 µ mの下引層を形成し、更に電 荷輸送材料として合成例10で作成したクロロガリウム フタロシアニン結晶を用いて膜厚 O. 15μmの電荷発 生層を形成し、その上にN, Nーピス(3, 4ージメチ ルフェニル)ビフェニルー4ーアミン(CT-1)を用

【O127】以下の構造式で表されるシラン化合物(C T-3) 10部と、ハードコート材(信越シリコン社 製、X-40-2239) 20部、フェニルトリエトキ シシラン3部、酢酸1部を混合させ、得られた塗布液 を、輸送層が形成された上に浸漬コーティング法で塗布 し、100°Cにおいて1時間加熱硬化させ、膜厚2. 5μmの表面保護層を形成し、電子写真感光体を得た。

いて膜厚15μmの電荷輸送層を形成した。

表16に示す。

	化合物	CTL バイ		画	質		
実施例	No.	ンダー	1枚2	ピー 後	2000₺	2000枚パー後	
16	(1)	(II)	良	好	良	好	
17	(1)	(III)	良	好	良	好	
18	(1)	(IV)	良	好	良	好	
19	(1)	(V)	良	好	良	好	
20	(1)	(VI)	良	好	良	好	
21	(1)	(VI)	良	好	良	好	
22	(6)	(II)	良	好	Đ.	好	
23	(6)	(IV)	良	好	良	好	
24	(13)	(II)	良	好	良	好	
25	(13)	(VI)	良	好	良	好	
26	(18)	(II)	良	好	良	纡	
27	(18)	(IV)	良	好	良	好	
比較例	NPha	(II)	良	好	一部、	かぶり	
1					を生じ	た	

【0125】(実施例28~46)電荷発生材料とシラ ン化合物との組合せを表16のように変え、実施例2~

[0128] 【化13】

【0129】このようにして得られた電子写真感光体を 実施例と同様に評価した。その結果を表16に示す。 【0130】 (実施例47~66) 電荷発生材料とシラ ン化合物との組合せを表17のように変え、実施例16 ~29と同様に電子写真感光体を作製し、評価した。結 果を表17に示す。

【0131】(比較例3)電荷輸送層として比較例1で 用いたシラン化合物(CT-3)を用いた以外は、比較 例2と同様に電子写真感光体を作成し、評価を行った。 その結果を表17に示す。

[0132]

【表 1 6 】

C-44 (%)	化合物	電荷発生	電荷輸送		酉	質	
実施例	No.	材料	材料	1枚2	- 後	2000枚	び- 後
28	29	CG-1	CT-1	良	好	良	好
29	30	CG-1	CT-1	良	紆	良	好
30	30	CG-2	CT-1	良	好	良	籽
31	30	CG-3	CT-1	良	17	良	好
32	30	CG-4	CT-1	臭_	好	良	好
33	31	CG-1	CT-1	良	好	良	纤
34	32	CG-1	CT-1	良	好	良	纡
35	35	C6-1	CT-1	良	好	良	好
36	36	CG-1	CT-1	良	奸	農	纡
37	37	CG-1	CT-1	良	纤	良	好
38	38	CG-1	CT-1	良	杆	良	好
39	29	CG-1	CT-2	良	纡	良	纤
40	30	CG-1	CT-2	良	好	良	好
41	31	CG-1	CT-2	庚	好	良	好
42	32	CG-L	CT-2	艮	好	良	釪
43	35	CG-1	CT-2	良	好	良	好
44	36	CG-1	CT-2	良	好	良	好
45	37	CG-1	CT-2	良	好	Ą	好
46	38	CG-1	CT-2	良	舒_	良	好
比較例	CT-3	CG-1	CT-1	若干の	5 流	若干の	画像流
2				n		n	

	化合物	CTL バイ	西	質	
実施例	No.	ンダー	1枚コヒー後	2000枚コヒー 後	
47	29	(VI)	良 好	良 好	
48	29	(WI)	良 奸	良 好	
49	30	(II)	良 好	良 好	
50	30	( <b>II</b> )	良 好	良 好	
51	30	(VI)	良 好	良 好	
52	30	(V)	良 好	良 好	
53	30	(VI)	良好	良 好	
54	30	(VI)	良 好	良 好	
55	31	(II)	良 好`	良 好	
56	31	(IV)	良好	良 好	
57	32	(II)	良好	良 好	
58	32	(IV)	良 好	良 好	
59	35	(111)	良 好	良 好	
60	35	(VI)	良 好	良好	
61	36	<b>(II)</b>	良 好	良 好	
62	36	(IV)	良 好	良 好	
69	37	(II)	良 好	良 好	
64	37	(IV)	良 好	良 好	
<b>6</b> 5	38	(III)	良 好	良 好	
66	38	(IV)	良 好	良 好	
比較例	CT-3	(II)	若干の画像流	若干の画像流	
3	Į		n	n	

【0134】表からわかるように、本実施例は、溶解性、成膜性、相溶性に優れたシラン化合物を用いているため、強固な膜を有し、このため優れた機械的強度及び繰り返し安定性を有し、且つ高感度であることがわかる。

## 【0135】(実施例67)

<下引層の作製>ホーニング処理した30mmφのアルミニウム円筒基板上にジルコニウム化合物(商品名:オルガチックス Z C 5 4 0、マツモト製薬社製)100部およびシラン化合物(商品名: A 1 1 1 0、日本ユンカー社製)10部とiープロパノール 400部およびブタノール200部からなる溶液を浸漬コーティング法で塗布し、150°Cにおいて10分間加熱乾燥し膜厚0.5μmの下引層を形成した。

【0136】<電荷発生層の作製>合成例9で合成されたクロロガリウムフタロシアニン結晶10部を、ポリビニルブチラール樹脂(商品名:エスレックBMーS、積水化学社製)10部および酢酸nーブチル500部と混合し、ガラスビーズとともにペイントシェーカーで1時間処理して分散した後、得られた塗布液を上記下引層上に浸漬コーティング法で塗布し、100°Cにおいて10分間加熱乾燥し、膜厚0.18μmの電荷発生層を形成した。

【0137】<電荷輸送層の作製>次にN、Nービス

(3、4ージメチルフェニル)ビフェニルー4ーアミン (CTM-1) 2部と、1、1'ージー (pーフェニレン) シクロヘキサンカーボネート3部を、モノクロロベンゼン20部に溶解し、得られた塗布液を、電荷発生層が形成されたアルミニウム円筒基板上に浸漬コーティング法で塗布し、120° Cにおいて1時間加熱乾燥を行い膜厚15μmの電荷輸送層を形成した。

【0138】 <表面保護層の作製>更に化合物(1)10 mと、パインダー(信越シリコン社製、X-40-2239)20部、フッ素含有化合物であるPTFE3部、1N-塩酸1部、ジブチルエーテル30部を15分間撹拌混合させ、得られた塗布液を、輸送層が形成された上に浸漬コーティング法で塗布し、120°Cにおいて1時間加熱乾燥した後更に80度(湿度80%)で1.5時間硬化させ、膜厚3μmの表面保護層を形成し、感光体を得た。

【0139】このようにして得られた電子写真用感光体を実機(XP-11:富士ゼロックス社製)に登載しB4のPPC用紙で1万枚の耐久試験を行った。その結果を表22に示す。

【0140】(実施例68~116)一般式(I)で表される化合物、フッ素含有化合物、触媒の組合せを表18、19の様に変え、実施例1と同様に電子写真用感光体を作製し、評価した。結果を表20、21、22に示す。

【 O 1 4 1 】 (比較例 4 ) 上記各実施例の表面保護層を 設けない電子写真用感光体を作成し、同様な評価を行っ た。結果を表 2 2 に示す。

【0142】(比較例5~13)電荷輸送材として一般式(I)で表される化合物の代わりにN、Nービス(3、4ージメチルフェニル)ビフェニルー4ーアミン(CTM-1)を用い、上記実施例68~116と同様にフッ素含有化合物、触媒の組合せを表19の様に変えて保護層を形成させたが、いずれも白化等により良好な保護層は得られなかった。

【0143】(比較例14)電荷輸送材として一般式(1)で表される化合物の代わりにN、Nービス(3、4ージメチルフェニル)ビフェニルー4ーアミン(CTM-1)を用い、更にバインダーとして前記の構造式(IV)で表されるポリカーボネートを用い、フッ素含有化合物としてF(CF2)8CH2CH2Si(OMe)3を用い前記実施例68~116と同様に保護層を形成させたが、相溶性が悪いため、白化してしまい良好な保護層は得られなかった。

[0144]

【表18】

実施例	化合物机	フッソ含有化合物	触媒	その他
67	(1)	PTFB	IN-HC1	
68	(4)	"	"	L
89	(8)	"	n	
70	(13)	"	"	
71	(15)	"	"	
72	(17)	"	"	
73	(1)	CF.CF.CH.OMe	"	
74	(4)	"	"	
75	(6)	"	"	
76	(19)	"	"	
77	(15)	~	"	
78	(17)	"	"	
79	(1)	F(CP;),C00Me	"	
80	(4)	"	"	
81	(6)	"	"	
82	(13)	"	N	
83	(15)	11	2	
84	(17)	"	N	
85	(1)-	F(CF <sub>z</sub> ),COOH		
86	(4)	"		
87	(6)	"		
88	(13)	"		
89	(15)	"		
90	(17)	N.		
91	(1)	P(CP <sub>2</sub> ),CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>		
92	(4)	u		
93	(6)	#		
94	(13)	"		
95	(15)	"		
96	(17)	"	-	<u> </u>

【表19】

[0145]

実施例	化合物No	フッソ含有化合	触媒	その他
97	(1)	P(CF <sub>2</sub> ),CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH	IN-RCI	
98	(4)	"	"	
99	(8)	"	"	
100	(13)	"	"	
101	(15)	"	"	
102	(17)	"	"	
103	(1)	F(CF <sub>1</sub> ).CH=CH <sub>2</sub>	"	hegi (986); 8/8 mg mg
104	(13)	"	"	"
105	(1)	F(CF:) CH4CH2Si(OMe).	"	
106	(4)	п	"	
107	(6)	"	"	
108	(13)	"	"	
109	(15)	"	"	
110	(17)	"		
111	(1)	CF,CH2CH2Si(OMe),	"	
112	(4)	"	~	
113	(6)	"	"	
114	(13)	"	"	
115	(15)	,,	"	
116	(17)	"	"	
比較例 5	CTM-1	PTFE		
6	*	CP,CP,CH,OMe	*	
7	*	F(CF <sub>2</sub> ) <sub>7</sub> COOMe		
8	~	P(CP <sub>2</sub> ),COOH		
9	"	P(CF2),CH2NH2		
10	11	F(CF2) CH2CH2OH	IN-HCI	
11	"	F(CF <sub>2</sub> ).CH=CH <sub>2</sub>	"	ME COLET : N/4 al
12	//	F(CF <sub>1</sub> ),CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Si(OMe) <sub>2</sub>	"	
13	"	CF, CH, CH, SI (OMe)	"	

[0146]

「寒っつ】

		1万枚コピー後の状態						
実施例	⊐ £	画質	原光体磨耗量 (nm)	感光体表面状態	<b>感光体付着物</b>			
67	良	好	410	良好	無し			
68	良	好	436	良 好	無し			
89	良	好	414	良 好	無し			
70	良	好	403	良好	無し			
71	良	紆	409	良好	無し			
72	良	好	405	良好	無し			
73	良	奸	650	良好	無し			
74	良	好	679	良好	無し			
75	良	奸	652	良好	無し			
76	良	好	613	良 好	無し			
77	良	纤	608	良好	無し			
78	良	舒	604	良好	無し			
79	良	好	483	良好	無し			
80	良	好	503	良好	無し			
81	良	好	472	良好	無し			
82	奥	好	426	良好	無し			
83	良	籽	411	良好	無し			
84	良	衧	416	良好	無し			
85	良	紆	497	良好	無し			
86	良	杆	489	良好	無し			
87	8	評	494	良好	無し			
88	良	好	478	良好	無し			
89	長	舒	481	贵 好	無し			
90	良	好_	475	良 奸	無し			

[0147]

I	表	2	1	)

	1万枚コピー後の状態						
実施例	コピー画質		感光体表面状態	感光体付着物			
91	良好	375	良 好	無し			
92	良好	369	良 好	無し			
93	良好	381	良 好	無し			
94	良好	359	良 好	無し			
95	良 好	367	良 好	無し			
96	良好	344	良好	無し			
97	良好	216	良 好	無し			
98	良 好	228	良 好	無し			
99	良 好	203	良 好	無し			
100	良 好	197	良好	無し			
101	良好	190	良好	無し			
102	良好	176	良 釪	無し			
103	良好	283	良 好	無し			
104	良好	259	良 好	無し			
105	良好	75	良好	無し			
108	良好	87	良好	無し			
107	良 好	79	良好	無し			
108	良好	43	良好	無し			
109	良好	40	良好	無し			
110	良好	29	良好	無し			
111	良 好	206	良好	無し			
112	良 好	219	良好	無し			
113	良好	201	良好	無し			
114	良 好	185	良好	無し			

[0148]

【表22】

			1×1 - 1			
実施例	1万枚コピー後の状態					
	コピー画質	感光体磨耗量 (nm)	感光体表面状態	总光体付着物		
115	良好	194	良好	無し		
116	良好	182	良 好	無し		
比較例	優吳處桑壓	880	若干の傷	若干の付着物		

【0149】表18~22の結果より明らかなように、一般式(1)で表される化合物とフッ素含有化合物とを含有した実施例の電子写真感光体はいずれも強固な膜が形成され、耐久性、環境安定性が極めて優れており、且つ高感度であることがわかる。一方、フッ素含有化合物を含有しても、電荷輸送材として一般式(I)で表される化合物を含まないものは好適な保護層を形成しえないことがわかった。

【0150】(合成例13)

-化合物(112)の合成-

窒素置換した200mlの二ロフラスコに下記構造式で示されるカルボン酸(1)10.1gと1.8ージアザビシクロ[5,4,0]-7ーウンデセン4.6gをジメチルホルムアミド50mlに溶解させ、100度に加熱した。その後((クロロメチル)フェニルエチル)トリメトキシシラン7.6gを加え100度で4時間撹拌した。その後、トルエン500mlを加え、500ml

の蒸留水で二度洗浄し、有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥し、減圧下溶媒を除去した後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:トルエン/塩化メチレン)し、淡黄色油状のシラン化合物(112)7.1gを得た。得られたシラン化合物のIR吸収スペクトルを図9に示す。

[0151]

【0152】(合成例14)

-化合物(150)の合成-

窒素置換した200mlのナス型フラスコに下記構造式

で示されるカルボン酸(2)14.3gと1.8-ジアザビシクロ[5,4,0]-7-ウンデセン7.3gをジメチルホルムアミド50mlに溶解させ、100度に加熱した。その後((クロロメチル)フェニルエチル)トリメトキシシラン12.4gを加え100度で6時間撹拌した。その後、トルエン500ml及び蒸留水300mlを加え、析出した不溶分をセライトを通しろ別した。誘起層を500mlの蒸留水で二度洗浄し、無水硫

酸ナトリウムを加えて乾燥し、減圧下溶媒を除去した 後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:トルエン/塩化メ チレン)し、淡黄色油状のシラン化合物(150)1 2.1gを得た。得られたシラン化合物のIR吸収スペ クトルを図10に示す。

【0153】 【化15】

## 【0154】(合成例15)

-化合物(111)の合成-

窒素置換した300m I の二ロフラスコに上記構造式で示されるカルボン酸(1)5.0gとアリルアルコール5.0gを取り、100m I のトルエンに溶解させた。更に濃硫酸1m I を滴下し15時間撹拌した。その後、200m I の蒸留水に注ぎ二度洗浄を行い、有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥し、減圧下溶媒を除去し

た後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:トルエン)し、 更に再結晶法により精製し下記構造式で示されるビニル 基含有エステル(1)5.2gを得た(融点107~1 09°C、白色結晶)。得られた化合物のIR吸収スペ クトルを図11に示す。

【0155】 【化16】

【0156】窒素置換した200m Iの二ロフラスコにビニル基含有エステル(1)3gとトリメトキシシラン3gを取り、撹拌しながらH2PtCl66H2O(1%イソプロパノール溶液)を0.1m I滴下したところ、反応の進行とともに原料が溶解した。そのまま3時間撹拌した後トルエン50m Iを加え蒸留水100m Iに注ぎ洗浄をした。更に有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥し、減圧下溶媒を除去した後、シリカゲルでカラム精製(溶剤:トルエン/酢酸エチル)し、淡黄色

油状のシラン化合物(111)7.1gを得た。得られたシラン化合物のIR吸収スペクトルを図12に示す。 (実施例117~124)実施例2~9と同様にシラン化合物(111)、(150)についても、電荷輸送材料、電荷発生材料の組合せを下記表23の様に変え、電子写真感光体を作成し評価を行った。

【0157】 【表23】

実施例	化合物	電荷発生	電荷輸送	画質			
	No.	材料	材料	1枚2	ピー 後	2000枚	コヒー 後
117	111	CG-1	CT-1	良	好	良	好
118	111	CG-2	CT-1	良	好	良	好
119	111	CG-3	CT-1	良	好	良	好
120	111	CG-4	CT-I	良	好	良	好
121	150	CG-1	CT-1	良	好	良	好
122	150	CG-2	CT-1	良	好	良	好
123	150	CG-3	CT-1	良	好	良	好
124	150	CG-4	CT-1	良	好	良	好

【0158】表からわかるように、本実施例は、溶解性、成膜性、相溶性に優れたシラン化合物を用いている

ため、強固な膜を有し、このため優れた機械的強度及び 繰り返し安定性を有し、且つ高感度であることがわか る。

(実施例125~128) 実施例16~29と同様にシ ラン化合物(111)、(150)についても、パイン ダーの組合せを下記表24の様に変え、電子写真感光体 を作成し評価を行った。

### [0159]

【表24】

[衣 4 4	<i>1</i>					
	化合物	CTL パイ		画	質	
実施例	No.	ンダー	1枚フヒー後		2000枚パー後	
125	111	(N)	良	好	良	好
126	111	(V)	良	好	良	好
127	150	(IV)	良	好	良	好
128	150	(V)	良	好	良	好

【0160】表からわかるように、パインダーとの組み 合わせにおいても、強固な膜を有し、このため優れた機 械的強度及び繰り返し安定性を有し、且つ高感度な電子 写真感光体が得られることがわかる。

【0161】(実施例129~144)一般式(1)で 表される化合物、フッ素含有化合物、触媒の組合せを表 25の様に変え、実施例1と同様に電子写真用感光体を 作製し、評価した。結果を表26に示す。

[0162] 【表25】

実施例	施例 化合物Na フッソ含有化合物		触媒		
129	111	PTFE	IN-HC1		
130	111	CF3CF2CH20Me	"		
131	111	F(CF <sub>2</sub> ),COOMe	.,		
132	111	F(CF <sub>2</sub> ), COOH			
133	111	F(CF <sub>2</sub> ), CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>			
134	111	F(CF <sub>2</sub> ), CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> DH	1N-HC1		
135	111	F(CF <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Si(OMe) <sub>a</sub>	"		
136	111	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Si(OMe) <sub>9</sub>	"		
137	150	PTFE	IN-HC1		
138	150	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OMe	"		
139	150	F(CF <sub>2</sub> ),COOMe	"		
140	150	F(CF <sub>2</sub> ),COOH			
141	150	F(CF <sub>2</sub> ) <sub>7</sub> CH <sub>8</sub> NH <sub>2</sub>			
142	150	F(CF <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	LN-HC1		
143	150	F(CF <sub>2</sub> ) <sub>a</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Si(OMe) <sub>a</sub>	(e) <sub>3</sub> "		
144	150	CF, CH2CH2Si (OMe),	"		

[0163]

【表26】

	1万枚コピー後の状態					
実施例	コピー画質	感光体磨耗量	感光体表面状態	感光体付着物		
129	良好	430	良 好	無し		
130	良好	642	良好	無し		
131	良好	453	良 好	無し		
132	良好	527	良 好	無し		
133	良好	405	良 好	無し		
134	良好	254	良 好	無し		
135	良好	91	良 好	無し		
136	良好	232	良好	無し		
137	良好	411	良 好	無し		
138	良 好	625	良 好	無し		
139	良 好	423	良 好	無し		
140	良好	509	良好	無し		
141	良好	416	良好	無し		
142	良 好	225	良好	無し		
143	良好	65	良好	無し		
144	良好	210	良 好	無し		

た実施例の電子写真感光体はいずれも強固な膜が形成さ れ、耐久性、環境安定性が極めて優れており、且つ高感 度であることがわかる。即ち、フッ素含有化合物との組 み合わせにおいて、より効果の向上がみられることがわ かった。

#### [0165]

【発明の効果】本発明は、溶解性、成膜性、相溶性に優 れた化合物を用いるので、強固な膜が形成され、機械的 強度が向上した高感度で環境安定性に優れた電子写真感 光体を提供することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】合成例1で合成されたシラン化合物の1R吸収 スペクトルである。

【図2】合成例2で合成されたシラン化合物のIR吸収 スペクトルである。

【図3】合成例3で合成されたシラン化合物のIR吸収 スペクトルである。

【図4】合成例4で合成されたシラン化合物のIR吸収

スペクトルである。

【図5】合成例5で合成されたシラン化合物の1R吸収 スペクトルである。

【図6】合成例6で合成されたシラン化合物の1R吸収 スペクトルである。

【図7】合成例7で合成されたシラン化合物のIR吸収 スペクトルである。

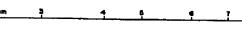
【図8】合成例8で合成されたシラン化合物の1R吸収 スペクトルである。

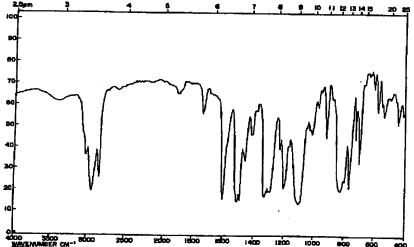
【図9】合成例13で合成されたシラン化合物のIR吸 収スペクトルである。

【図10】合成例14で合成されたシラン化合物のIR 吸収スペクトルである。

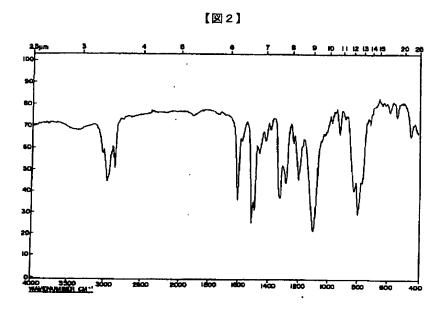
【図11】合成例15で合成された中間体であるビニル 基含有エステル化合物のIR吸収スペクトルである。

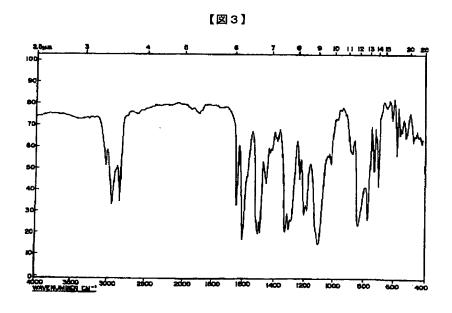
【図12】合成例15で合成されたシラン化合物のIR 吸収スペクトルである。

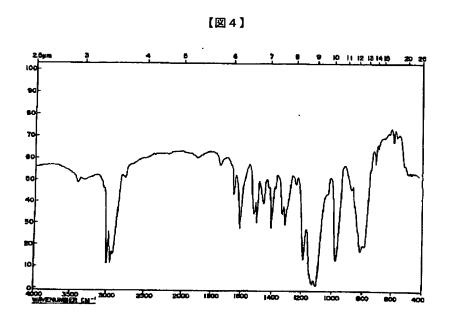


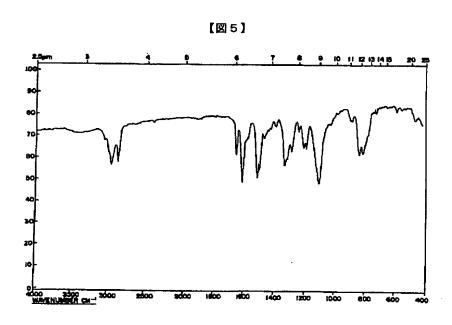


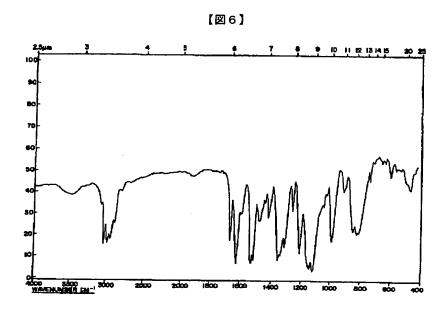
【図1】

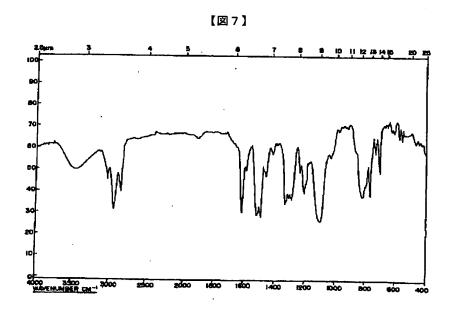


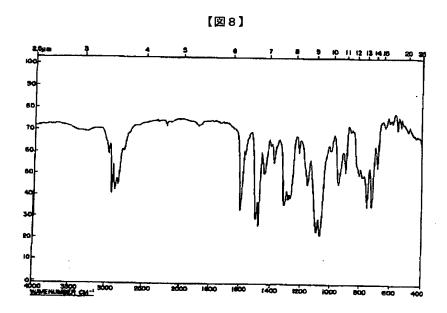


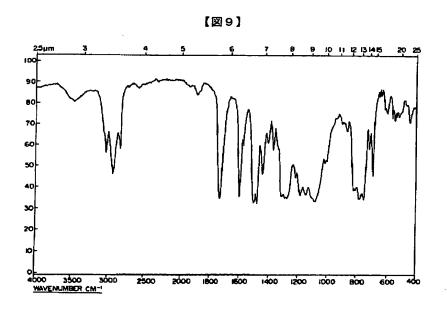


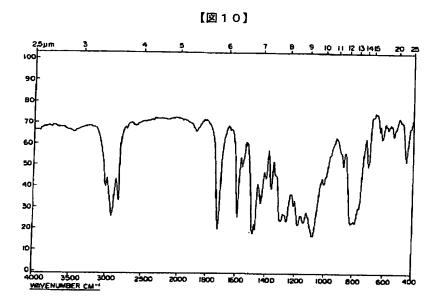


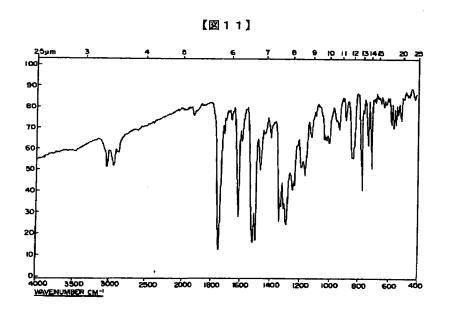


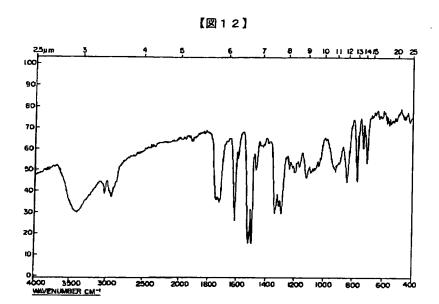












## **ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR**

Patent Number:

JP11038656

Publication date:

1999-02-12

Inventor(s):

YAMADA WATARU; NUKADA KATSUMI; IWASAKI MASAHIRO

Applicant(s):

**FUJI XEROX CO LTD** 

Requested Patent:

☐ JP11038656

Application Number: JP19970190236 19970715

Priority Number(s):

IPC Classification:

G03G5/06; G03G5/06; G03G5/05; G03G5/05

EC Classification:

Equivalents:

JP3264218B2

### Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrophotographic photoreceptor having enhanced mechanical strength, high sensitivity and good resistance to circumstantial changes by using a compound superior in solubility, film-forming property and compatibility and forming a strong film. SOLUTION: This photoreceptor provided with plural layers contains in one of the layers at least one kind of fluorine compound, if necessary and at least one kind of compound represented by the formula, in which each of Ar1 -Ar4 is, independently, an aryl group, and Ar5 is an aryl or arylene group; X is a group of -Y-Si(R1)(3-a) O(R2)a; R1 is an H atom or an alkyl or aryl group; R2 is an H atom or an alkyl or trialkylsilyl group; (a) is 1, 2, or 3; Y is a divalent group excluding the ones having an H atom linking directly to a hetero atom, for example, -CONH- and -NH-; and (k) is 0 or 1.

Data supplied from the esp@cenet database - 12